



KAYIPLI ORTAMLarda
ELEKTROMAGNETİK DALGA YAYILIMININ
ZAMANDA SONLU FARKLAR METODU İLE
ANALİZİ VE SİMÜLASYONU

ÖMER HALİL ÇOLAK
YÜKSEK LİSANS TEZİ
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
ANABİLİM DALI

ISPARTA 2003

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

135865

KAYIPLI ORTAMLARDA ELEKTROMAGNETİK DALGA YAYILIMININ
ZAMANDA SONLU FARKLAR METODU İLE
ANALİZİ VE SİMÜLASYONU

HAZIRLAYAN
ÖMER HALİL ÇOLAK

DANIŞMAN
PROF. DR. MUSTAFA MERDAN

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ISPARTA, 2003

135865

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Bu çalışma jürimiz tarafından ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ANABİLİM DALI'nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir.

Başkan : Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ 

Üye : Prof. Dr. Mustafa MERDAN 

Üye : Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇÖMLEKÇİ 

ONAY

Bu tez 13.01.2003 tarihinde Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen yukarıdaki jüri üyeleri tarafından kabul edilmiştir.

22.01.2003
S.D.U. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ
Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
İÇİNDEKİLER	i
ÖZET	ii
ABSTRACT	iii
TEŞEKKÜR	iv
SİMGELER DİZİNİ	v
ŞEKİLLER DİZİNİ	vi
ÇİZELGELER DİZİNİ	viii
1. GİRİŞ	1
2. KAYNAK BİLGİSİ VE METOT	2
2.1 Zamanda Sonlu Farklar Yöntemi	2
2.2 FDTD İle Serbest Uzayın Bir Boyutlu Simülasyonu	6
2.3 FDTD Metodu ve Kararlılık	8
2.4 YEE' nin Sonlu Farklar Algoritması	9
3. BULGULAR VE TARTIŞMA	18
3.1 Dielektrik Bir Ortamda Yayılım	18
3.2 Kayıplı Bir Ortamda Yayılım	23
3.3 Kullanılan Akı Yoğunluğunun Yeniden Formülayonu	31
3.4 Frekans Domeni Çıkış Hesabı	38
3.5 Frekansa Bağlı Ortamlar	43
3.5.1 Yardımcı Diferansiyel Eşitlik Metodu	45
3.5.2 z Dönüşümü Kullanılarak Formülasyon	47
4. SONUÇ	56
5. KAYNAKLAR	58
ÖZGEÇMİŞ	59

ÖZET

Bu çalışmada elektromanyetik dalga yayılım problemleri için, zamanda sonlu farklar algoritması kullanılarak, farklı ortamlarda dalga hareketlerinin analizleri yapılmış ve bunlarla ilgili simülasyonlar gerçekleştirılmıştır. Analitik yöntemlerle çözümü mevcut olan bir elektromanyetik problemin, deneysel olarak modellenebilmesindeki zorluklar, bu çözümlerin bilgisayar ortamına adaptasyonunu gerekliliktedir. Ancak analitik yöntemlerle yapılan çözümlerin yazılım kodlarına uygun olmamasına bağlı olarak ortaya çıkan problem, zamanda sonlu farklar yöntemiyle çözümler yapılarak ortadan kaldırılmıştır. Yapılan yazılımların, parametrelerin kullanıcı tarafından değişimine imkan verecek şekilde tasarımlı, bu yazılımların, daha birçok, aynı tür, kompleks problemlerin çözümünde kullanılabilirliğini sağlamıştır. Bu programlar sonucunda elektrik alan ve manyetik alan değerleri ile Fourier genliği farklı ortam geçişleri için simüle edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER: Zamanda Sonlu Farklar Yöntemi, Elektromanyetik Dalga Yayılımı

ABSTRACT

In this thesis, the wave propagation in different environment is analyzed and simulated using finite difference time domain algorithm. Because there are some difficulties to make an experimental model for the electromagnetic problems which have been solved analytically, computational methods have been used to solve these problems. Application of the solutions obtained by analytical method to the computer environment has created an adaptation problem. This problem has been solved using finite difference time domain method. Computer programs are written to solve variety of problems, using changeable parameters. Using these software, electric field, magnetic field and Fourier amplitude are simulated in different environment.

KEY WORDS: Finite Difference Time Domain Method, Electromagnetic Wave Propagation

TEŞEKKÜR

Bu çalışmanın hazırlanmasında gerekli ortamı hazırlayan ve çalışmanın her safhasında yardımlarını esirgemeyen Sayın Prof. Dr. Mustafa MERDAN'a, kaynak temin etme ve yazılımlar konusunda verdiği destek ile çalışmanın sonuca ulaşmasında yön gösterici olan Zürih Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Niyazi ARI'ya, bu tez çalışmasının gerçekleştirilmesi için eleştiri ve önerileriyle çalışmaya ışık tutan ve atılan her adımda desteğiyle yanında olan Elektronik ve Haberleşme Yüksek Mühendisi Şükrü Özen'e, katkılarından dolayı Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇÖMLEKÇİ, Yrd. Doç. Dr. Ali MANZAK ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Övünç POLAT'a teşekkür ederim.

SİMGELER DİZİNİ

$ca(k)$	Yazılım için Kullanılan Parametre
$cb(k)$	Yazılım için Kullanılan Parametre
eaf	Yazılım için Kullanılan Parametre
B	Manyetik Akı Yoğunluğu
D	Elektrik Akı Yoğunluğu
E	Elektrik Alan
\tilde{E}	Normalize Elektrik Alan
f	frekans
H	Manyetik Alan Siddeti
I	FDTD Çözüm için Yardımcı Parametre
kc	İkinci Ortam Sınırı
S	FDTD Çözüm için Yardımcı Parametre
T	Zaman Adımı
w	Açısal Frekans
X_1	Suseptans
δ	Yardımcı Parametre
ϵ_0	Boşluğun Dielektrik sabiti
ϵ_r	Bağıl Dielektrik sabiti
μ_0	Boşluğun Manyetik Geçirgenlik Katsayısı
μ_r	Bağıl Manyetik Geçirgenlik Katsayısı
Δx	x Yönündeki Hücre Mesafesi
Δy	y Yönündeki Hücre Mesafesi
Δz	z Yönündeki Hücre Mesafesi
σ	İletkenlik
τ	Yansıma Katsayısı
Γ	İletim Katsayısı
YDE	Yardımcı Diferansiyel Eşitlik Metodu
FDTD	Zamanda Sonlu Farklar Metodu

ŞEKİLLER DİZİNİ

	Sayfa
Şekil 2.1. Farklar tasarımının gösterilimi	3
Şekil 2.2. FDTD Formülasyonunda E ve H alanlarının zaman ve konumda ayrışimleri	7
Şekil 2.3 Yee örgüsünün bir birim hücresinde alan bileşenlerinin pozisyonları ..	10
Şekil 2.4 3D Yee Birim Hücresi	12
Şekil 2.5 100 zaman adımından sonra serbest uzayda bir darbenin FDTD simülasyonu	16
Şekil 2.6 150 zaman adımından sonra serbest uzayda bir darbenin FDTD simülasyonu	16
Şekil 2.7 200 zaman adımından sonra serbest uzayda bir darbenin FDTD simülasyonu	17
Şekil 3.1. T=100 için dielektrik sabiti 4 olan bir ortamın simülasyon sonuçları ..	21
Şekil 3.2. T=220 için dielektrik sabiti 4 olan bir ortamın simülasyon sonuçları ..	21
Şekil 3.3. T=250 için dielektrik sabiti 4 olan bir ortamın simülasyon sonuçları ..	22
Şekil 3.4. T=350 için dielektrik sabiti 4 olan bir ortamın simülasyon sonuçları ..	22
Şekil 3.5. T=250 için dielektrik sabiti 40 olan bir ortamın simülasyon sonuçları.	23
Şekil 3.6. Dielektrik sabiti 4, iletkenliği 0.003(S/m) olan kayıplı bir ortama çarpan sinüsoidal dalganın simülasyonu	27
Şekil 3.7. Dielektrik sabiti 4, iletkenliği 0.04 (S/m) olan kayıplı bir ortama çarpan sinüsoidal dalganın simülasyonu	28
Şekil 3.8. Dielektrik sabiti 4, iletkenliği 0.04(S/m) olan kayıplı bir ortama çarpan Gauss darbesinin simülasyonu (T=150)	29
Şekil 3.9. Dielektrik sabiti 4, iletkenliği 0.04(S/m) olan kayıplı bir ortama çarpan Gauss darbesinin simülasyonu (T=275)	29
Şekil 3.10. Dielektrik sabiti 4, iletkenliği 0.04(S/m) olan kayıplı bir ortama çarpan Gauss darbesinin simülasyonu (T=350)	30
Şekil 3.11. Dielektrik sabiti 10, iletkenliği 0.2 (S/m) olan kayıplı bir ortama çarpan Gauss darbesinin simülasyonu (T=275)	30

Şekil 3.12. Dielektrik sabiti 10, iletkenliği 0.2 (S/m) olan kayıplı bir ortama çarpan Gauss darbesinin simülasyonu (T=350)	31
Şekil 3.13. T=200 ve T=300 için dielektrik bir ortama çarpan darbenin simülasyonu	37
Şekil 3.14. T=200 de, darbe ortama çarpmadan önce frekans tepkisi ve elektrik alan	40
Şekil 3.15. T=350 de, darbe ortama çarptıktan sonra Fourier genliği (f =150 MHz)	40
Şekil 3.16. T=350 de, darbe ortama çarptıktan sonra Fourier genliği (f =300 MHz)	41
Şekil 3.17. T=350 de, darbe ortama çarptıktan sonra Fourier genliği (f =500 MHz)	41
Şekil 3.18. T=350 de, darbe ortama çarptıktan sonra frekans tepkisi ve elektrik alan	42
Şekil 3.19. T=200 için elektrik alan değeri	49
Şekil 3.20. T=250 ve T=400 için elektrik alan değerleri	50
Şekil 3.21. 50 MHz için frekansa bağlı Fourier genliği değişimi (nsteps=500)	51
Şekil 3.22. 200 MHz için frekansa bağlı Fourier genliği değişimi (nsteps=500) ..	51
Şekil 3.23. 500 MHz için frekansa bağlı Fourier genliği değişimi (nsteps=500) ..	52
Şekil 3.24. Fourier genliği değişimi (nsteps=500)	52
Şekil 3.25. 1-MHz için frekansa bağlı Fourier genliği değişimi (nsteps=500)	53
Şekil 3.26. 10-MHz için frekansa bağlı Fourier genliği değişimi (nsteps=500)	54
Şekil 3.27. 100-MHz için frekansa bağlı Fourier genliği değişimi (nsteps=500) ..	54
Şekil 3.28. 100 Her üç frekans için Fourier genliği değişimi (nsteps=500)	55

ÇİZELGELER DİZİNİ

	Sayfa
Çizelge 2.1 Boşlukta 1D FDTD simülasyonu için hazırlanan yazılım	14
Çizelge 3.1. Dielektrik ortama çarpan darbenin simülasyonu için hazırlanan Yazılım	19
Çizelge 3.2. Kayıplı ortamların simülasyonu için hazırlanan yazılım	25
Çizelge 3.3. Dielektrik bir ortama çarpan darbenin simülasyon yazılımı	34
Çizelge 3.4. Ortam parametreler dizisi	49



1. GİRİŞ

Literatürde kısaca FDTD olarak bilinen zamanda sonlu farklar yöntemi, İngilizce Finite Difference Time Domain kelimelerinin kısaltılmasıdır. Yöntem, diferansiyel formdaki Maxwell denklemelerinin doğrudan zamanda ve konumda, merkezi farklar yöntemine göre ayıraltırlıp iteratif olarak adım adım çözülmesine dayanır. İlk kez 1966 yılında ortaya atılmasından buyana FDTD, hemen her türlü elektromanyetik problem çözümlerinde kullanılan bir yöntem olmuştur (Taflove, 1995).

Yöntemin öncelikli uygulamaları, farklı türdeki ortamlarda darbe iletimi, geniş bantlı analizler ile özellikle biyomedikal alanında doku analizleri üzerine olmuştur. Bu uygulamalarda FDTD yöntemi, önceleri ele alınan ortam içerisinde ilgilenilen cisimlerin yakın civarındaki alanların hesabında kullanılmıştır. Atmosferden biyolojik materyallere ve deniz altlarına kadar farklı özelliklere sahip her ortamda elektromanyetik saçılım ve yayılım karakteristiklerinin incelenmesinde ve gerekli çözümlemelerin yapılmasında yaygın olarak kullanılan bir nümerik çözüm metodu olmuştur (Taflove, 1995).

FDTD yöntemi analitik türev operatörünün sayısallaştırılmasına dayanır ve FD sonlu farklar olarak isimlendirilir (Taflove, 1995). Ancak elektromanyetik dalga yayılmasını modelleyen Maxwell denklemelerinin FD ile, zamana göre türevlerinin de sayısallaştırılarak genelleştirilmesi, FDTD yöntemi adıyla özel olarak anılmaktadır. Zamanda sonlu farklar metodunu nümerik bir metot olarak adlandırılmasının yanında, özellikle bu araştırmada öne çıkan özelliği, bilgisayarla ilişkili bir metot (computational method) olmasıdır. Elektromanyetik teori için gerekli olan analitik çözümlerin uzun ve bilgisayar yazılımına pek elverişli olmaması, bu işlemlerin, bu tür bir metot ile yapılmasını gereklidir (Kunz ve Luebbers, 1993).

Bu çalışmada yapılan çözümlemeler, dielektrik sabiti ve iletkenliği frekansla değişmeyen herhangi bir ortam ve 1 MHz-1000 Mhz aralığında değişken dielektrik sabiti ve iletkenliğe sahip herhangi bir kayıplı ortam simülasyonu ile örneklenmiştir. Bu ortamlar için gerekli analitik çözümler en basit şekilde izah edilmiştir. Nümerik

çözümlemelerde, zamana ve konuma göre türevsel denklemlerin FDTD ile çözülmesiyle simülasyon için uygun denklemlere ulaşılmıştır. Hem analitik hem de FDTD çözümlemelerinde elde edilen denklemler MATLAB koduyla yazılıma dönüştürülmüştür ve simülasyonlar gerçekleştirilmiştir.

2. KAYNAK BİLGİSİ VE METOT

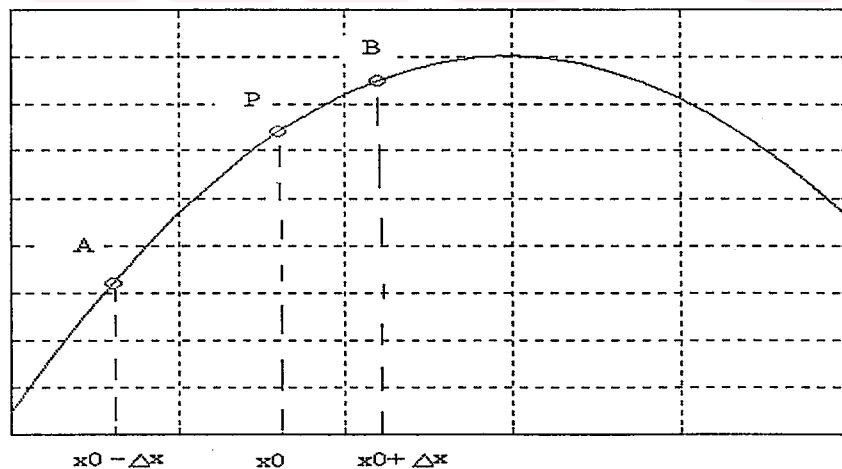
2.1 Zamanda Sonlu Farklar Yöntemi

Sonlu farklar çözümü temel olarak 3 adım içerir.

1. Düğümlerden oluşan ızgara şeklinde bir çözüm bölgesinin oluşturulması,
2. Diferansiyel denklemin, çözüm bölgesindeki herhangi bir noktadaki değerinin, komşu noktalardaki değerlere bağlı olarak değişen bir sonlu farklar denklemine dönüştürülmesi,
3. Önceden bilinen sınır şartları ve/veya başlangıç koşullarına bağlı olarak fark denklemlerinin çözülmESİ (Sadiku, 2000).

Verilen bir $f(x)$ fonksiyonunun x_0 noktasındaki türevi ileri sonlu farklar formülü ile (forward difference formula) şöyle tanımlanır.

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad (2.1)$$



Şekil 2.1. Farklar tasarımlının gösterilimi

Bu geriye sonlu farklar formülü ile şöyle ifade edilebilir.

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x} \quad (2.2)$$

Sonuç olarak AB 'nin eğimi, merkezi farklar formülü ile

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{2\Delta x} \quad (2.3)$$

şeklinde ifade edilir.

Bu noktadan hareketle $f(x)$ 'in P noktasındaki ikinci türevi hesaplanır.

$$\begin{aligned} f''(x_0) &\approx \frac{f'(x_0 + \Delta x/2) - f'(x_0 - \Delta x/2)}{\Delta x} \\ f''(x_0) &\approx \frac{1}{\Delta x} \left(\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - \frac{f(x_0) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x} \right) \\ f''(x_0) &\approx \frac{f(x_0 + \Delta x) - 2f(x_0) + f(x_0 - \Delta x)}{(\Delta x)^2} \end{aligned} \quad (2.4)$$

Taylor serisi açılımı kullanılarak aşağıdaki yaklaşıklar elde edilecektir.

$$f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + \Delta x \cdot f'(x_0) + \frac{1}{2!} (\Delta x)^2 \cdot f''(x_0) + \dots \quad (2.5)$$

$$f(x_0 - \Delta x) = f(x_0) - \Delta x \cdot f'(x_0) + \frac{1}{2!} (\Delta x)^2 \cdot f''(x_0) + \dots \quad (2.6)$$

$(\Delta x)^3$ 'lü terimler ihmali edilerek, 2.5 ve 2.6 denklemlerinin toplanması sonucunda

$$f(x_0 + \Delta x) + f(x_0 - \Delta x) = 2f(x_0) + (\Delta x)^2 \cdot f''(x_0)$$

$$f''(x_0) \approx \frac{f(x_0 + \Delta x) - 2f(x_0) + f(x_0 - \Delta x)}{(\Delta x)^2} \quad \text{olarak bulunur (Sadiku 2000).}$$

2.5 ve 2.6 denklemelerinde gerekli düzenlemeler yapılmınca,

$$f(x_0 + \Delta x) + f(x_0 - \Delta x) = 2\Delta x f'(x_0)$$

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{2\Delta x} \quad (2.7)$$

elde edilir. $f(x,t)$ fonksiyonunun, sonlu farklar metodu ile çözümünü bulmak için, $x-t$ düzlemindeki çözüm bölgesi yüzeyi, Δx ve Δt şeklinde, eşit biçimde dikdörtgenlere yada ağlara bölünür.

$$x = i \cdot \Delta x \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

$$t = j \cdot \Delta t \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

P noktasında f 'in değeri,

$$f_p = f(x, t) = f(i\Delta x, j\Delta t) = f(i, j) \text{ 'dir.}$$

Bu ifade ile merkezi farklar yaklaşımı kullanılarak (i,j) ninci düğümdeki f 'in türevleri bulunabilir.

$$f_{x|i,j} \approx \frac{f(i+1, j) - f(i-1, j)}{2\Delta x} \quad \text{ve} \quad f_{t|i,j} \approx \frac{f(i, j+1) - f(i, j-1)}{2\Delta t} \quad (2.8a)$$

$$f_{xx|i,j} \approx \frac{f(i+1, j) - 2f(i, j) + f(i-1, j)}{(\Delta x)^2} \quad \text{ve}$$

$$f_{tt|i,j} \approx \frac{f(i, j+1) - 2f(i, j) + f(i, j-1)}{(\Delta t)^2} \quad (2.8b)$$

2.2 FDTD ile Serbest Uzayın Bir Boyutlu Modeli

Serbest uzayda zamana bağlı Maxwell 'in curl denklemleri,

$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon_0} \nabla \times \mathbf{H} \quad (2.9a)$$

$$\frac{\partial \vec{\mathbf{H}}}{\partial t} = -\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{E} \quad (2.9b)$$

olarak yazılır. E ve H üç boyutlu vektörlerdir (Bu çalışmada vektörler koyu harflerle gösterilecektir). (2.9a) ve (2.9b) denklemleri E_x ve H_y 'nin kullanıldığı bir boyutlu durum için aşağıdaki şekilde düzenlenebilir.

$$\frac{\partial E_x}{\partial t} = -\frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial H_y}{\partial z} \quad (2.10a)$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial t} = -\frac{1}{\mu_0} \frac{\partial E_x}{\partial z} \quad (2.10b)$$

Bu denklemler, elektrik alanı x, manyetik alanı y doğrultusunda yönlendirilmiş ve z yönünde ilerleyen bir düzlemsel dalganın denklemleridir.

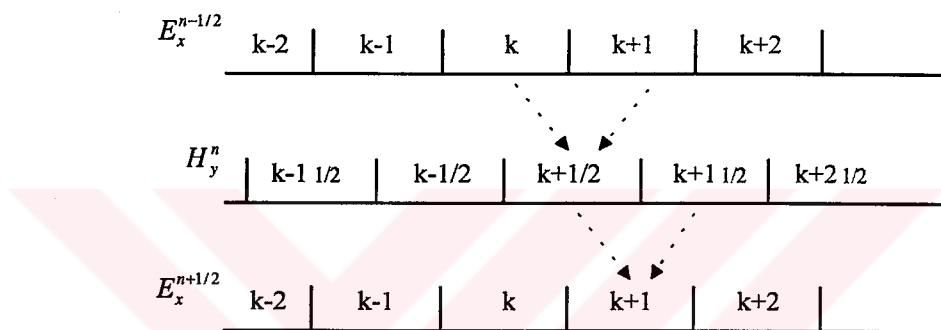
Geçici ve uzaysal türevlerin her ikisi ile beraber merkezi farklar yaklaşımı kullanılarak aşağıdaki denklemler elde edilir.

$$\frac{E_x^{n+1/2}(k) - E_x^{n-1/2}(k)}{\Delta t} = -\frac{1}{\epsilon_0} \frac{H_y^n(k+1/2) - H_y^n(k-1/2)}{\Delta x} \quad (2.11a)$$

$$\frac{H_y^{n+1}(k+1/2) - H_y^n(k+1/2)}{\Delta t} = -\frac{1}{\mu_0} \frac{E_x^{n+1/2}(k+1) - E_x^{n+1/2}(k)}{\Delta x} \quad (2.11b)$$

Burada n zamanı belirtir ve $t = \Delta t \cdot n$ şeklinde ifade edilir. Simülasyonda gerekli kod yazılımı için her şeyin ayrıştırılması zorunludur. $n+1$ terimi bir sonraki zaman adımını ifade eder. Parantezdeki terimler mesafeyi gösterir. k mesafeyi belirtir ve

kullanımının daha fazla duyarlılık sağladığını görülebilir. Bununla birlikte uzaysal artışlarda genel olarak Δx kullanılır ve burada da Δx kullanılmıştır). 2.11a ve 2.11b denklemleri **E** ve **H** alanlarının mesafeyle ve zamana bağlı olarak birbirinden ayrıldığını farz eder. **E** alan değerleri arasına yerleştirilmiş olarak kabul edilen **H** alan değerlerini göstermek için $k+1/2$ ve $k-1/2$ ifadeleri kullanılır. Bu şekilde 2.11 de gösterilmektedir. Benzer olarak $n+1/2$ ve $n-1/2$ ifadeleri de sırasıyla n 'den önceki ve n 'den sonraki değerleri göstermektedir. 2.11a ve 2.11b iterasyonla oluşturulan bir algoritmayla yeniden düzenlenenebilir.



Şekil 2.2. FDTD Formülasyonunda **E** ve **H** alanlarının zaman ve konumda ayırmaları.

$$E_x^{n+1/2}(k) = E_x^{n-1/2}(k) - \frac{\Delta t}{\epsilon_0 \cdot \Delta x} [H_y^n(k+1/2) - H_y^n(k-1/2)] \quad (2.12a)$$

$$H_y^{n+1}(k+1/2) = H_y^n(k+1/2) - \frac{\Delta t}{\mu_0 \cdot \Delta x} [E_x^{n+1/2}(k+1) - E_x^{n+1/2}(k)] \quad (2.12b)$$

Dikkat edilmelidir ki hesaplamalar zaman ve mesafe olarak birbirinden ayrılmıştır. Örneğin 2.12a denkleminde E_x 'in yeni değeri, önceki E_x değerinden ve H_y 'nin son değerlerinden hesaplanır. Bu, zamanda sonlu farklar metodunun temel paradigmasıdır (Umashankar ve Taflove, 1993). 2.12a ve 2.12b denklemleri birbirine çok benzerdir fakat buradaki fark ϵ_0 ve μ_0 'in genlik değerinde oluşturduğu farktır, dolayısıyla E_x ve H_y genlik yönünden farklı olacaktır. Bundan aşağıdaki değişiklik yapılarak kaçınırlar.

$$\tilde{E} = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \vec{E} \quad (2.13)$$

Burada \tilde{E} normalize elektrik alan değeridir.

$$\tilde{E}_x^{n+1/2}(k) = \tilde{E}_x^{n-1/2}(k) - \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \frac{\Delta t}{\Delta x} [H_y^n(k+1/2) - H_y^n(k-1/2)] \quad (2.14a)$$

$$H_y^{n+1}(k+1/2) = H_y^n(k+1/2) - \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \frac{\Delta t}{\Delta x} [\tilde{E}_x^{n+1/2}(k+1) - \tilde{E}_x^{n+1/2}(k)] \quad (2.14b)$$

Hücre boyutu Δx seçildiğinde, zaman adımı Δt hesaplanabilir.

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{2 \cdot c_0} \quad (2.15)$$

Burada c_0 serbest uzayda ışığın hızıdır. Buna bağlı olarak,

$$\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \frac{\Delta t}{\Delta x} = c_0 \cdot \frac{\Delta x / 2 \cdot c_0}{\Delta x} = 1/2 \quad (2.16) \text{ olarak hesaplanır.}$$

2.3 FDTD Metodu ve Kararlılık

Zaman adımının nasıl hesaplanıldığı çok önemli bir kavramdır. Yayılımda gerekli olan hücre mesafesi için minimum $\Delta t = \Delta x / c_0$ zamanı gereklidir. Eğer iki boyutlu simülasyon yapılyorsa çift yönde yayılma izin verilmesi zorunludur. Bu durumda

gerekken zaman $\Delta t = \frac{\Delta x}{\sqrt{2}c_0}$ şeklindedir. 3 boyutlu simülasyon için de $\Delta t = \frac{\Delta x}{\sqrt{3}c_0}$

olacaktır. İyi bilinen “Courant Condition” ile bu ifade edilebilir.

$$\Delta t \leq \frac{\Delta x}{\sqrt{n}c_0} \quad (2.17)$$

Burada n simülasyon boyutudur. Bu çalışmada $\Delta t = \frac{\Delta x}{2 \cdot c_0}$ olarak kabul edilmiştir. Bu

en geçerli formül olmamakla beraber, basit olduğu ve simülasyonu kolaylaştırdığı için bu ifade kullanılacaktır.

2.4 YEE' nin Sonlu Farklar Algoritması

1966' da Kane YEE $\rho'=0$ ve $\sigma=0$ olan kayıpsız malzemelerde zamana bağlı Maxwell'in curl denklemleri için bir sonlu farklar denklem grubu oluşturdu (Taflove, 1995). Yee' nin geliştirdiği algoritma bir dalga denklemiyle elektrik alanın ve manyetik alanın tek başına çözümünden ziyade, Maxwell' in curl denklemleri kullanılarak zaman ve mesafeye bağlı şekilde elektrik ve manyetik alanın her ikisini de çözer. \mathbf{E} ve \mathbf{H} bilgisinin her ikisinin de kullanılarak çözüm yapılması, çözümü daha kuvvetli kılar. Elektrik ve manyetik alanın her ikisinin de mevcut veya elde edilebilir olduğu durumda kenar ve köşelere yakın teğetsel manyetik alan özelliklerini, ince tellerin yakınındaki manyetik alan özelliklerini, kenarlarda ve ince teller yakınındaki elektriksel alan değerleri gibi herhangi bir alan bilgisi tek başına modellenebilir. Sonuç olarak Yee algoritması, eşzamanlı olarak, Maxwell denklemlerinin makroskopik integral formu ve diferansiyel formunun simülasyonunu sağlar (Taflove, 1995).

İzotropik bir ortamda Maxwell denklemleri

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad (2.18a)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \sigma \mathbf{E} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (2.18b)$$

olarak yazılabilir (Taflove, 1995).

2.18 denklemlerindeki vektör, kartezyen koordinat sisteminde belirtilen, altı tane skaler denklemden oluşan bir sistemi ifade eder.

$$\frac{\partial H_x}{\partial t} = \frac{1}{\mu} \left(\frac{\partial E_y}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial y} \right) \quad (2.19a)$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial t} = \frac{1}{\mu} \left(\frac{\partial E_z}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial z} \right) \quad (2.19b)$$

$$\frac{\partial H_z}{\partial t} = \frac{1}{\mu} \left(\frac{\partial E_x}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial x} \right) \quad (2.19c)$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon} \left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} - \sigma E_x \right) \quad (2.19d)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon} \left(\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} - \sigma E_y \right) \quad (2.19e)$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon} \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} - \sigma E_z \right) \quad (2.19f)$$

Yee' nin notasyonunu takip edersek, çözüm bölgesindeki bir ızgara noktasını

$$(i, j, k) = (i\Delta x, j\Delta y, k\Delta z) \quad (2.20)$$

olarak ve mesafe ile zamanın fonksiyonunu

$$F^n(i, j, k) = F(i\delta, j\delta, k\delta, n\Delta t) \quad (2.21)$$

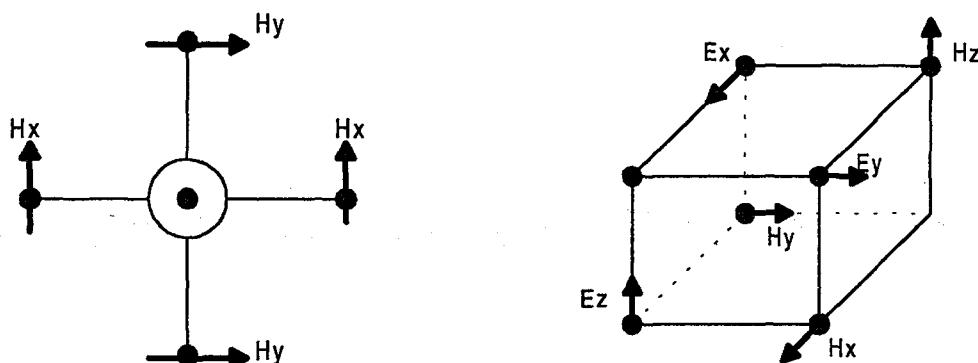
olarak tanımlayabiliriz.

Burada i, j, k ve n tam sayı olmak üzere $\delta = \Delta x = \Delta y = \Delta z$ mesafedeki artışı ve Δt zamandaki artışı ifade eder. Uzay ve zaman türevleri için merkezi farklar yaklaşımı kullanılarak,

$$\frac{\partial F^n(i, j, k)}{\partial x} = \frac{F^n(i + 1/2, j, k) - F^n(i - 1/2, j, k)}{\delta} + O(\delta^2) \quad (2.22)$$

$$\frac{\partial F^n(i, j, k)}{\partial t} = \frac{F^{n+1/2}(i, j, k) - F^{n-1/2}(i, j, k)}{\Delta t} + O(\Delta t^2) \quad (2.23)$$

2.19' daki uzaysal türevlerin tümüne 2.22 denklemi uygulandığında, şekil 3.2 de gösterildiği gibi örgünün bir birim hücresinde, E ve H alan bileşenleri pozisyonlanır.



Şekil 2.3 Yee örgüsünün bir birim hücresinde alan bileşenlerinin pozisyonları

Bu denklemlere bağlı olarak 2.19 denkleminin sonlu farklar yaklaşımı

$$\begin{aligned} H_x^{n+1/2}(i, j+1/2, k+1/2) &= H_x^{n-1/2}(i, j+1/2, k+1/2) \\ &+ \frac{\delta t}{\mu(i, j+1/2, k+1/2)\delta} [E_y^n(i, j+1/2, k+1) - E_y^n(i, j+1/2, k)] \\ &+ E_z^n(i, j, k+1/2) - E_z^n(i, j+1, k+1/2) \end{aligned} \quad (2.24a)$$

$$\begin{aligned} H_y^{n+1/2}(i+1/2, j, k+1/2) &= H_y^{n-1/2}(i+1/2, j, k+1/2) \\ &+ \frac{\delta t}{\mu(i+1/2, j, k+1/2)\delta} [E_z^n(i+1, j, k+1/2) - E_z^n(i, j, k+1/2)] \\ &+ E_x^n(i+1/2, j, k) - E_x^n(i+1/2, j, k+1) \end{aligned} \quad (2.24b)$$

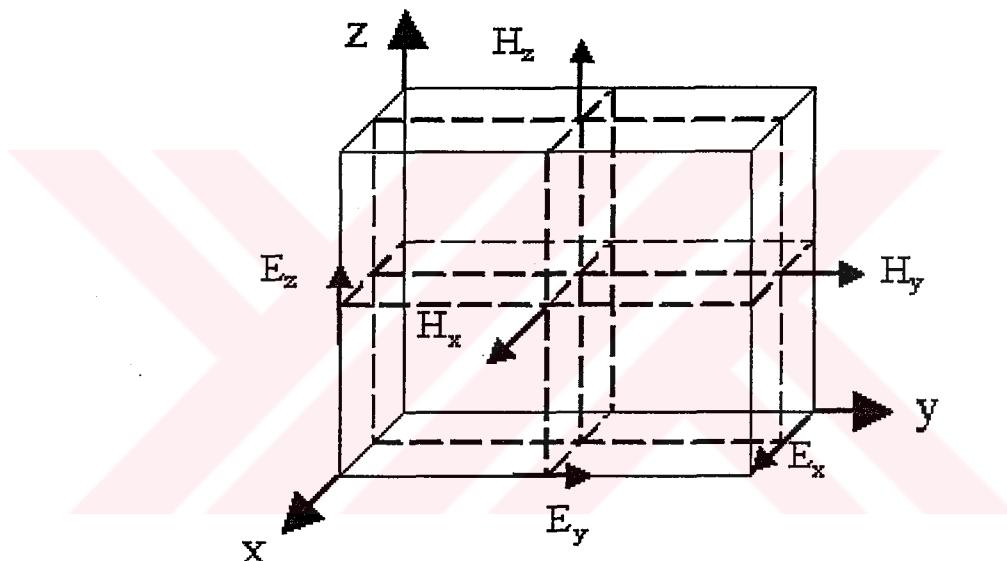
$$\begin{aligned} H_z^{n+1/2}(i+1/2, j+1/2, k) &= H_z^{n-1/2}(i+1/2, j+1/2, k) \\ &+ \frac{\delta t}{\mu(i+1/2, j+1/2, k)\delta} [E_x^n(i+1/2, j+1, k) - E_x^n(i+1/2, j, k)] \\ &+ E_y^n(i, j+1/2, k) - E_y^n(i+1, j+1/2, k) \end{aligned} \quad (2.24c)$$

$$\begin{aligned} E_x^{n+1}(i+1/2, j, k) &= \left(1 - \frac{\sigma(i+1/2, j, k)\delta t}{\varepsilon(i+1/2, j, k)}\right) E_x^n(i+1/2, j, k) \\ &+ \frac{\delta t}{\varepsilon(i+1/2, j, k)\delta} [H_z^{n+1/2}(i+1/2, j+1/2, k) - H_z^{n+1/2}(i+1/2, j-1/2, k)] \\ &+ H_y^{n+1/2}(i+1/2, j, k-1/2) - H_y^{n+1/2}(i+1/2, j, k+1/2) \end{aligned} \quad (2.24d)$$

$$\begin{aligned} E_y^{n+1}(i, j+1/2, k) &= \left(1 - \frac{\sigma(i, j+1/2, k)\delta t}{\varepsilon(i, j+1/2, k)}\right) E_y^n(i, j+1/2, k) \\ &+ \frac{\delta t}{\varepsilon(i, j+1/2, k)\delta} [H_x^{n+1/2}(i, j+1/2, k+1/2) - H_x^{n+1/2}(i, j+1/2, k-1/2)] \\ &+ H_z^{n+1/2}(i-1/2, j+1/2, k) - H_z^{n+1/2}(i+1/2, j+1/2, k) \end{aligned} \quad (2.24e)$$

$$\begin{aligned}
 E_z^{n+1}(i, j, k + 1/2) = & \left(1 - \frac{\sigma(i, j, k + 1/2)\delta t}{\epsilon(i, j, k + 1/2)} \right) E_z^n(i, j, k + 1/2) \\
 & + \frac{\delta t}{\epsilon(i, j, k + 1/2)\delta} [H_y^{n+1/2}(i + 1/2, j, k + 1/2) - H_y^{n+1/2}(i - 1/2, j, k + 1/2) \quad (2.24f) \\
 & + H_x^{n+1/2}(i, j - 1/2, k + 1/2) - H_x^{n+1/2}(i, j + 1/2, k + 1/2)]
 \end{aligned}$$

olarak ifade edilir (Taflove, 1995; Inumaru ve Hashimoto, 2000).



Şekil 2.4 3D Yee Birim Hücresi

Şekil 2.4 de verilen Yee birim hücresi incelendiğinde FDTD yapısı için şu noktaların altını çizmek önemlidir.

1. Her hücrede 3 elektrik alan ve 3 manyetik alan bileşeni vardır; hücre numarası (i, j, k) olarak ifade edilmektedir.
2. (i, j, k) hücresinde, örneğin elektrik alanın x bileşeni $E_x(i, j, k)$ ve manyetik alanın y bileşeni $H_y(i, j, k)$ aynı indislerle belirtilmelerine karşın hücre içerisindeki konumları farklıdır. Elektrik alan bileşenleri hücrenin soldaki üç

kenarın ortalarında, manyetik alan bileşenleri ise yine soldaki üç yüzey ortalarında tanımlıdır.

3. Hücre içerisinde farklı konumda olmalarının yanı sıra elektrik ve manyetik alan bileşenleri arasında zamanda da $\Delta t/2$ kadar fark vardır. Yani $t=0$, $\Delta t, 2\Delta t, \dots$ anlarında elektrik alan bileşenleri hesaplanırken $t=\Delta t/2, 3\Delta t/2$ anlarında manyetik alan bileşeni hesaplanır.
4. FDTD uzayında herhangi bir noktada alan bileşenleri komşu noktalardaki bileşenlerin aritmetik ortalaması ile bulunur. Örneğin (i,j,k) hücresinin merkezindeki E_z' ’i bulmak için

$$E_z' = \frac{E_z(i, j, k) + E_z(i+1, j, k) + E_z(i, j+1, k) + E_z(i+1, j+1, k)}{4} \quad (2.25)$$

kullanılmaktadır.

5. FDTD hacmi içerisindeki yüz binlerce hücrede, zaman iterasyonu boyunca (V/m) olarak elektrik alan ve (A/m) olarak manyetik alan değerleri hesaplanmaktadır. Herhangi bir noktada istenilen alan bileşenleri biriktirilerek $E(t)$ ve $H(t)$ zaman değişimi elde edilebilir. Bu sayede yapının hem geçici hem de sürekli zaman davranışını gözlemezbilmektedir. Zaman davranışından da Fourier dönüşümü ile $E(f)$ ve/veya $H(f)$ frekans davranışını çıkabilir.
6. FDTD hacmi içinde kaynak uygulama problemi oldukça kolay bir şekilde çözümlenebilmektedir. Modelenen yapıya ve gerçekleştirilmek istenen analize bağımlı olarak kaynağın farklı noktalara ve farklı şekilde uygulanması gerekebilir. Kaynak tek bir noktada tek bir bileşene uygulanabileceği gibi, birden fazla noktada ve/veya birkaç bileşene de uygulanabilir.
7. FDTD hacmi içerisindeki tüm hücrelerde elektrik ve manyetik alan bileşenleri hesaplandığı için, yapının herhangi bir noktasındaki gerilim ve akım değerlerini hesaplamak mümkündür. Genel olarak x_1 ve x_2 olarak

tanımlanan iki nokta arasında t anındaki potansiyel farkı, iki noktayı birleştiren doğru üzerindeki elektrik alanın integrali alınarak bulunabilir. Sayısal olarak ise, herhangi bir (i,j,k) hücresindeki gerilim ve akım Gauss ve Amper yasasından elde edilir. Örneğin V_z ve I_z

$$V_z(i, j, k) = -E_z(i, j, k) \times \Delta z \quad (2.25)$$

$$I_z(i, j, k) = [H_x(i, j-1, k) - H_x(i, j, k)] \times \Delta x + [H_y(i, j, k) - H_y(i-1, j, k)] \times \Delta y \quad (2.26)$$

Bu denklem ve algoritmalarla bağlı olarak, 2.14a ve 2.14b denklemleri bilgisayar koduna şu şekilde dönüştürülür.

$$Ex(k) = Ex(k) + 0.5 * (Hy(k-1) - Hy(k)) \quad (2.27a)$$

$$Hy(k) = Hy(k) + 0.5 * (Ex(k) - Ex(k+1)) \quad (2.27b)$$

* işaret programda çarpma işlemini tanımlamaktadır.

Burada n, (n+1/2) ve (n-1/2) ifadeleri bulunmadığına dikkat edilmelidir. FDTD metotta zaman, imha edilir. 2.27a denkleminde eşitliğin sağ tarafındaki Ex değeri, n-1/2 de ki önceki Ex değerini, sol taraftaki Ex değeri ise n+1/2 anındaki son Ex değerini göstermektedir. Bununla beraber pozisyonlar açıkça belirtilmiştir. Tek fark program içinde gösterilmekte (k+1/2) ve (k-1/2) yerine k ve (k-1) kullanılmasıdır.

Çizelge 2.1 Boşlukta 1D FDTD simülasyonu için hazırlanan yazılım

%f1d11.m BOSLUKTA 1D FDTD SİMÜLASYONU

%SABİTLER

KE=200; %Kullanılacak Hücre Sayısı

to=40; %Gelen darbenin merkezi

kc=KE/2; %Problem uzayının merkezi

spread=12; %Gelen darbenin genişliği

Eo=1;

T=0;

dt=0.5; %Zaman Adımı

dx=0.5;

Çizelge 2.1 devam

```

Nstep=150;    % iterasyon sayısı (değiştirilebilir)
%ilk şartlar
for k=1:KE+1
    Ex(k)=0;
    Hy(k)=0;
end

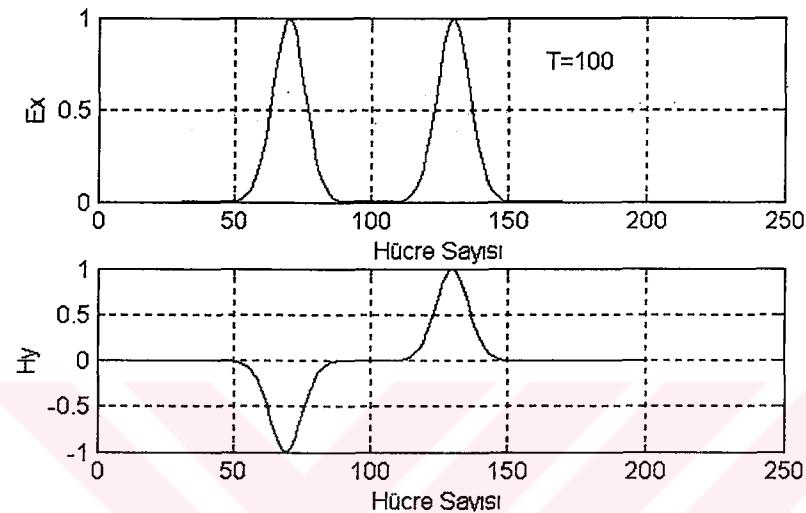
%Gauss darbesi
for n=1:Nstep
    T=T+1;
    for k=2:KE
        Ex(k)=Ex(k)+0.5*(Hy(k-1)-Hy(k));
        pulse=exp(-0.5*((to-T)/spread)^2);
        Ex(kc)=pulse;
    end
    for k=2:KE
        Hy(k)=Hy(k)+0.5*(Ex(k)-Ex(k+1));
    end
end

subplot(2,1,1);
plot(Ex);
xlabel('Hücre Sayısı');
ylabel('Ex');

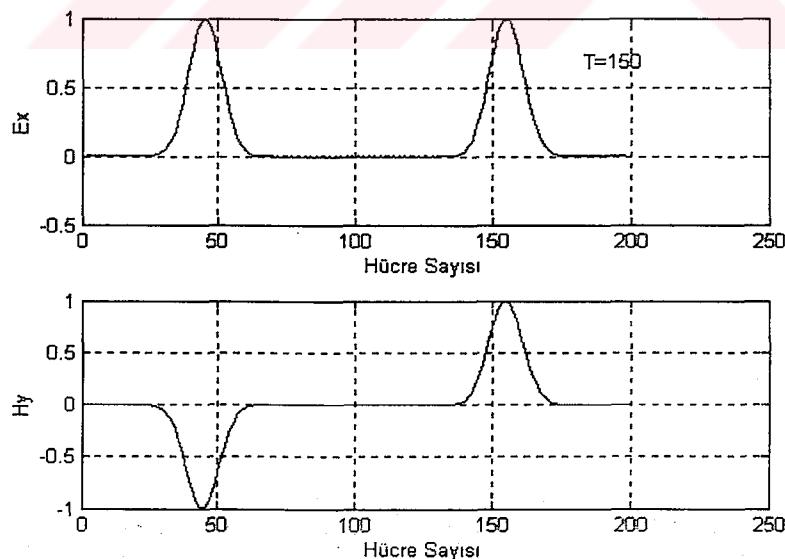
subplot(2,1,2);
plot(Hy);
xlabel('Hücre Sayısı');
ylabel('Hy');

```

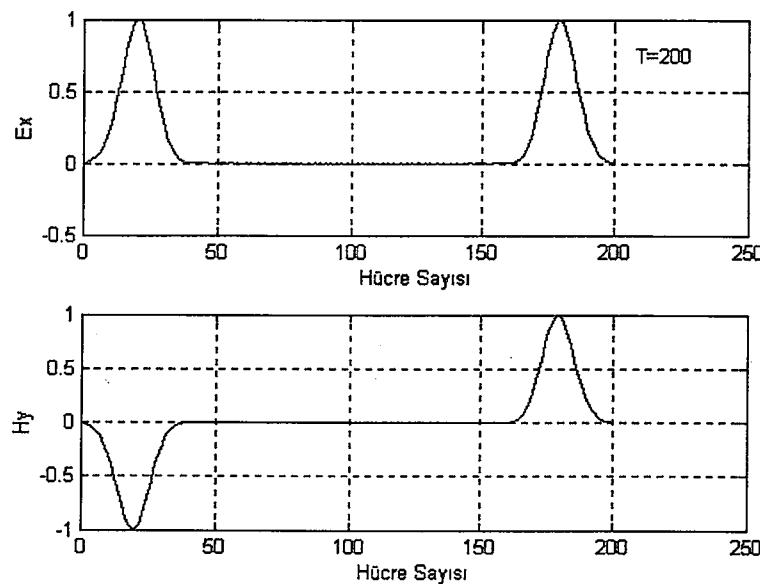
2) f1d11.m programı temel, bir boyutlu FDTD programıdır. Program, problem uzayının merkezinde bir Gaussian darbesi üretir ve darbe şekil 1.2 de gösterildiği gibi her iki yönde yayılır. Her iki yönde de E_x alanı pozitiftir, fakat H_y alanı negatif yönde negatif değerler alır.



Şekil 2.5 100 zaman adımdan sonra serbest uzayda bir darbenin FDTD simülasyonu



Şekil 2.6 150 zaman adımdan sonra serbest uzayda bir darbenin FDTD simülasyonu



Şekil 2.7 200 zaman adımından sonra serbest uzayda bir darbenin FDTD simülasyonu

Programla ilgili dikkate değer noktalar şöyle belirtilebilir.

- 1) E_x ve H_y değerleri ayrı döngülerle hesaplanır ve yukarıda tanımlandığı gibi birbirinden ayrı çalışır.
- 2) E_x değeri hesaplandıktan sonra kaynak hesaplanır. $k=k_c$ noktasındaki E_x 'in değeri basitçe belirlenir. Bu "hard source" olarak tanımlanır, belirli bir değer FDTD ızgarası üzerine uygulanır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1 Dielektrik Bir Ortamda Yayılım

Dielektrik sabiti birden farklı olan, yani boşluk olmayan bir ortamındaki yayılımın simülasyonunu gerçekleştirebilmek için öncelikle bağlı dielektrik sabiti ϵ_r , Maxwell denklemlerine ilave edilir (Grote,2000).

$$\frac{\partial E}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon_r \epsilon_0} \nabla \times H \quad (3.1a)$$

$$\frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{1}{\mu_0} \nabla \times E \quad (3.1b)$$

Burada yapılacak olan yine bir boyutlu simülasyondur. Denklem 2.13, yeniden düzenlenirse,

$$\frac{\partial \tilde{E}_x(t)}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon_r \sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \frac{\partial H_y(t)}{\partial z}$$

$$\frac{\partial H_y(t)}{\partial t} = -\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \frac{\partial \tilde{E}_x(t)}{\partial z}$$

ve sonlu farklar yaklaşımı kullanılırsa,

$$\frac{\tilde{E}_x^{n+1/2}(k) - \tilde{E}_x^{n-1/2}(k)}{\Delta t} = \frac{1}{\epsilon_r \sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \cdot \frac{H_y^n(k+1/2) - H_y^n(k-1/2)}{\Delta x} \quad (3.2a)$$

$$\frac{H_y^{n+1}(k+1/2) - H_y^n(k+1/2)}{\Delta t} = -\frac{1}{\mu_0} \cdot \frac{\tilde{E}_x^{n+1/2}(k+1) - \tilde{E}_x^{n+1/2}(k)}{\Delta x} \quad (3.2b)$$

denklemleri elde edilir.

$\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \frac{\Delta t}{\Delta x} = \frac{1}{2}$ olduğuna göre bunu 3.2 denkleminde uygularsak,

$$\tilde{E}_x^{n+1/2}(k) = \tilde{E}_x^{n-1/2}(k) + \frac{1/2}{\epsilon_r} [H_y^n(k+1/2) - H_y^n(k-1/2)] \quad (3.3a)$$

$$H_y^{n+1}(k+1/2) = H_y^n(k+1/2) - \frac{1}{\mu_0} [\tilde{E}_x^{n+1/2}(k+1) - \tilde{E}_x^{n+1/2}(k)] \quad (3.3b)$$

denklemlerine ulaşılır.

Bu denklemlere bağlı olarak program için gerekli kodlar belirlenebilir.

$$Ex(k) = Ex(k) + cb(k) * (Hy(k-1) - Hy(k)) \quad (3.4a)$$

$$Hy(k) = Hy(k) + 0.5 * (Ex(k) - Ex(k+1)) \quad (3.4b)$$

Burada dielektrik malzemeyi belirten k'nın değerleri üzerinde

$$cb(k) = .5 / \text{epsilon} \quad (3.5) \text{ olur.}$$

Çizelge 3.1. Dielektrik ortama çarpan darbenin simülasyonu için hazırlanan yazılım

```
%f1d13.m Dielektrik ortama çarpan darbenin simülasyonu
KE=200;
to=40;
kc=KE/2;
spread=12;
T=0;
%Nstep=100;
%Nstep=220;
Nstep=400;
kstart=100;
epsilon=4;
%ilk şartlar
for k=1:KE+1
    Ex(k)=0;
    Hy(k)=0;
end
```

Çizelge 3.1. devam

```
for k=1:KE+1
    cb(k)=0.5;
end
for k=kstart:KE+1
    cb(k)=0.5/epsilon;
end

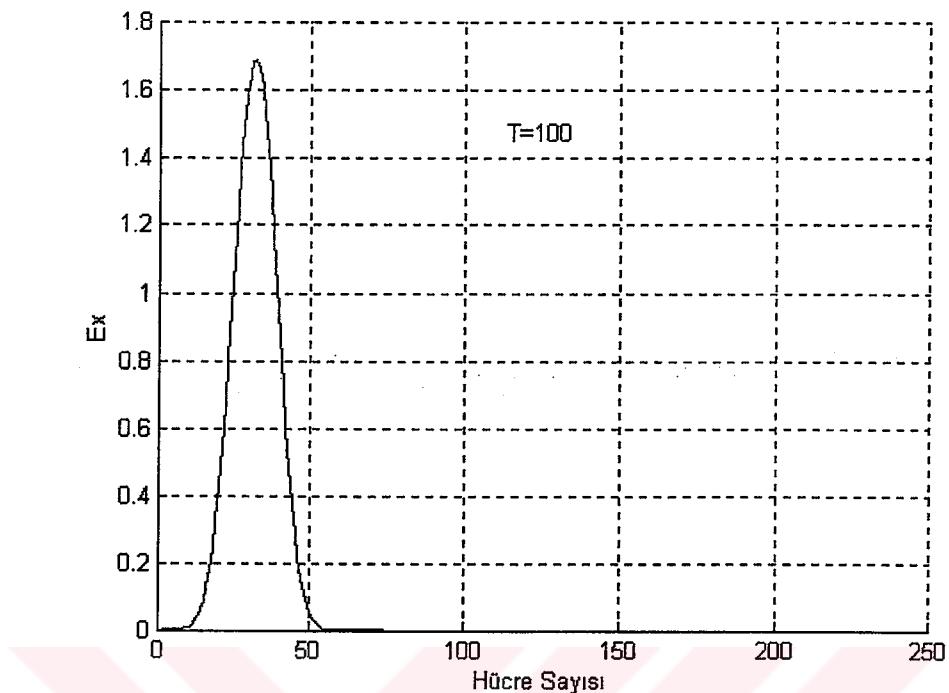
%gauss darbesi
for n=1:Nstep
    T=T+1;

    for k=2:KE
        Ex(k)=Ex(k)+cb(k)*(Hy(k-1)-Hy(k));
    end

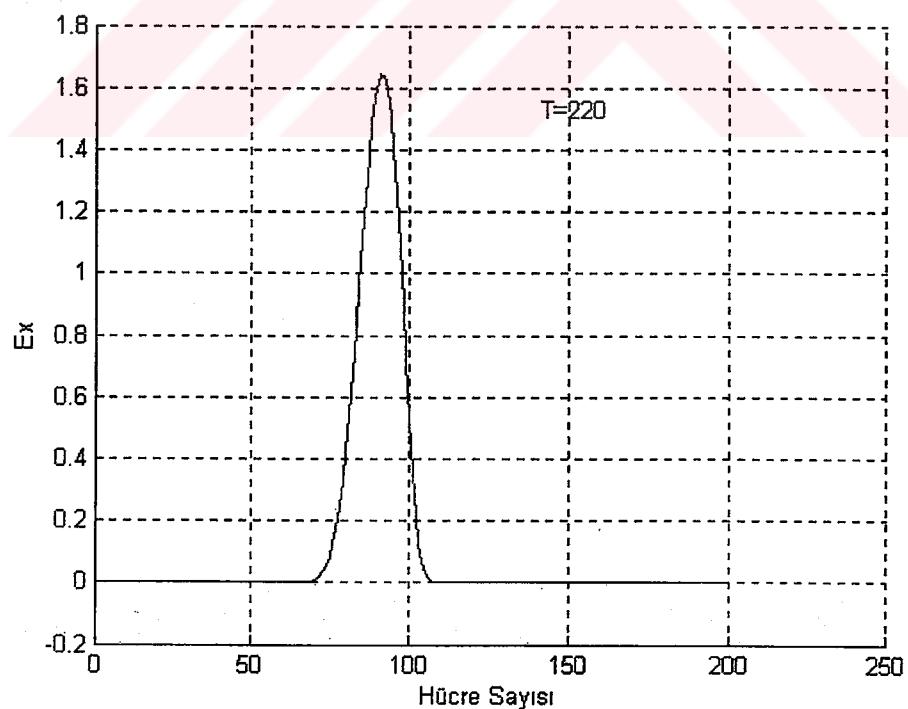
    pulse=exp(-0.5*((to-T)/spread)^2);
    Ex(5)=Ex(5)+pulse;

    for k=2:KE
        Hy(k)=Hy(k)+0.5*(Ex(k)-Ex(k+1));
    end
end

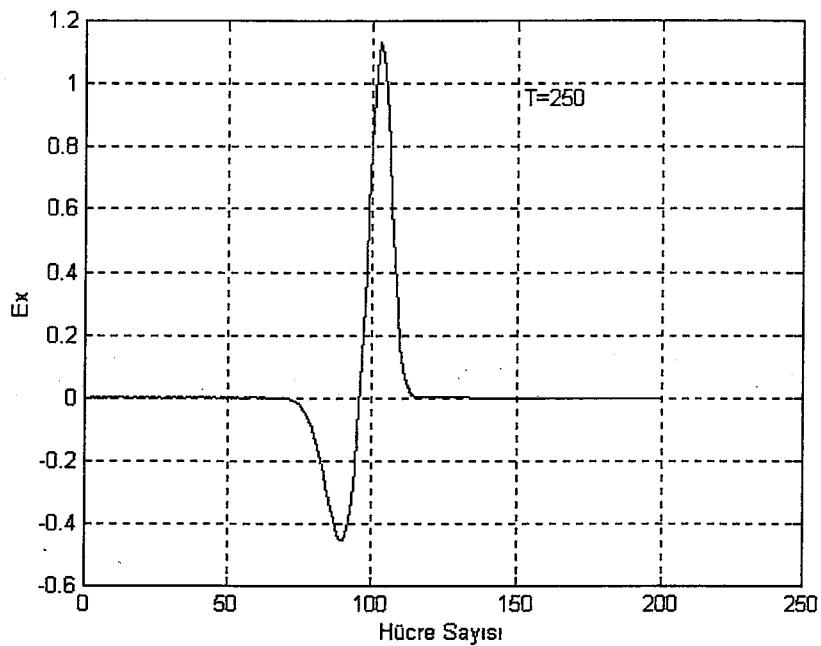
plot(Ex);
xlabel('Hücre Sayısı');
ylabel('Ex');
```



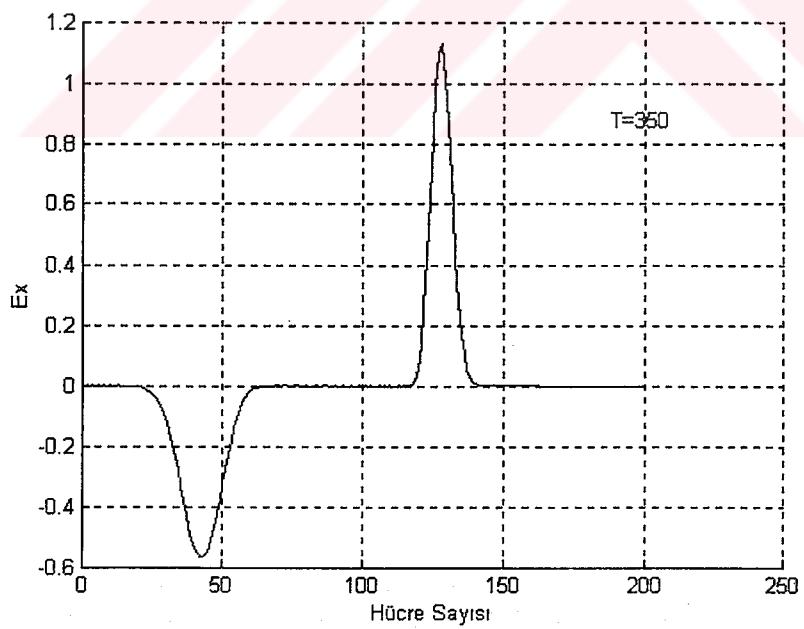
Şekil 3.1 $T=100$ için dielektrik sabiti 4 olan bir ortamın simülasyon sonuçları



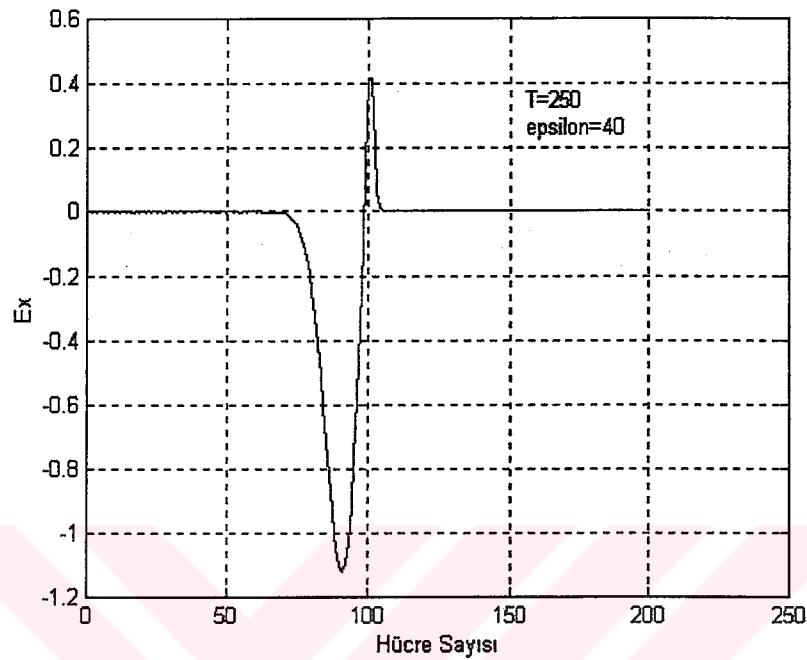
Şekil 3.2 $T=220$ için dielektrik sabiti 4 olan bir ortamın simülasyon sonuçları



Şekil 3.3 $T=250$ için dielektrik sabiti 4 olan bir ortamın simülasyon sonuçları



Şekil 3.4 $T=350$ için dielektrik sabiti 4 olan bir ortamın simülasyon sonuçları



Şekil 3.5 $T=250$ için dielektrik sabiti 40 olan bir ortamın simülasyon sonuçları

f1d13.m programında boşlukta ilerleyip dielektrik bir ortama çarpan darbenin simülasyonu yapılmıştır. Bu ortam (3.15) eşitliğindeki cb parametresi ile açıkça belirtilmiştir. Şekil 3.1, Şekil 3.2 ve Şekil 3.3 dielektrik sabiti 4 olan bir ortamın simülasyon sonuçlarını göstermektedir. Değişen sadece iterasyon sayısıdır. Burada, EM teorinin temel prensiplerine göre darbenin bir kısmı ortam içerisinde ilerlerken bir kısmı da geri yansımaktadır.

3.2 Kayıplı Bir Ortamda Yayılım

Şimdiye kadar yapılan simülasyonlar, bağıl dielektrik sabiti ϵ_r 'nin belirtildiği basit bir ortamın yada serbest uzaydaki elektromanyetik yayılının simülasyonlarıdır. Bununla birlikte, birçok ortam iletkenlik olarak belirtilen bir kayıp terimine sahiptir. Bu kayıp sonucunda yayılan enerjide zayıflama meydana gelir. Önce zamana bağlı Maxwell' in Curl denklemleri ele alınıp, bunlar, iletkenliği olan bir ortamdaki yayılımı simule etmek için daha genel bir formda yazılmalıdır.

$$\epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \nabla \times \mathbf{H} - \mathbf{J} \quad (3.6a)$$

$$\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = -\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{E} \quad (3.6b)$$

\mathbf{J} akım yoğunluğu olup $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ 'dir. Burada σ iletkenlidir. Bu, (3.6a) denkleminde yazılıp dielektrik sabitine bölünürse,

$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon_r \epsilon_0} \nabla \times \mathbf{H} - \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r} \mathbf{E} \quad \text{olur.}$$

Temel bir boyutlu simülasyon denklemi düzenlenirse,

$$\frac{\partial E_x(t)}{\partial t} = -\frac{1}{\epsilon_r \epsilon_0} \cdot \frac{\partial H_y(t)}{\partial z} - \frac{\sigma}{\epsilon_r \epsilon_0} E_x(t)$$

ve (2.13)denklemindeki değişken dönüşümü yapılrsa,

$$\frac{\partial \tilde{E}_x(t)}{\partial t} = -\frac{1}{\epsilon_r \sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \cdot \frac{\partial H_y(t)}{\partial z} - \frac{\sigma}{\epsilon_r \epsilon_0} \tilde{E}_x(t) \quad (3.7a)$$

$$\frac{\partial H_y(t)}{\partial t} = -\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \frac{\partial \tilde{E}_x(t)}{\partial z} \quad (3.7b)$$

denklemleri elde edilir.

(2.11) denklemine benzer olarak, konuma ve zamana bağlı türevlerin her ikisi içinde, sonlu farklar yaklaşımı ele alındığında,

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{E}_x^{n+1/2}(k) - \tilde{E}_x^{n-1/2}(k)}{\Delta t} &= -\frac{1}{\epsilon_r \sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \frac{H_y^n(k+1/2) - H_y^n(k-1/2)}{\Delta x} \\ &- \frac{\sigma}{\epsilon_r \epsilon_0} \frac{\tilde{E}_x^{n+1/2}(k) + \tilde{E}_x^{n-1/2}(k)}{2} \end{aligned} \quad (3.8)$$

denklemine ulaşılır.

Daha önce elde ettiğimiz,

$$\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \frac{\Delta t}{\Delta x} = \frac{1}{2} \quad \text{denklemi kullanarak,}$$

$$\tilde{E}_x^{n+1/2}(k) \left[1 + \frac{\Delta t \cdot \sigma}{2\varepsilon_r \varepsilon_0} \right] = \tilde{E}_x^{n-1/2}(k) \left[1 - \frac{\Delta t \cdot \sigma}{2\varepsilon_r \varepsilon_0} \right] - \frac{1/2}{\varepsilon_r} [H_y^n(k+1/2) - H_y^n(k-1/2)] \quad (3.9)$$

denklemi elde edilir. Bu denklemler, artık, program için gerekli kodlara dönüştürülebilir.

$$Ex(k) = ca(k) * Ex(k) + cb(k) * (Hy(k-1) - Hy(k)) \quad (3.9a)$$

$$Hy(k) = Hy(k) + 0.5 * (Ex(k) - Ex(k+1)) \quad (3.9b)$$

Burada

$$eaf = dt * sigma / (2 * epsz * epsilon) \quad (3.10a)$$

$$ca(k) = (1 - eaf) / (1 + eaf) \quad (3.10b)$$

$$cb(k) = 0.5 / (epsilon * (1 + eaf)) \quad (3.11c)$$

Çizelge 3.2. Kayıplı ortamların simülasyonu için hazırlanan yazılım

```
%f1d15.m Kayıplı ortamın simülasyonu
```

```
KE=200;
```

```
to=40;
```

```
kc=KE/2;
```

```
spread=12;
```

```
T=0;
```

```
Nstep=200;%Nstep değiştirilebilir
```

```
kstart=100;
```

```
ddx=0.01;
```

```
dt=ddx/(6e8);
```

```
epsz=8.85419e-12;
```

```
%ilk şartlar
```

```
%f=700e6;
```

Çizelge 3.2. (devam)

```
%sigma=0.003;
sigma=0.04;
epsilon=4;
for k=1:KE+1
    ca(k)=1;
    cb(k)=0.5;
end
eaf=dt*sigma/(2*epsz*epsilon);

for k=1:KE+1
    Ex(k)=0;
    Hy(k)=0;
end

for k=kstart:KE+1
    ca(k)=(1-eaf)/(1+eaf);
    cb(k)=0.5/(epsilon*(1.+eaf));
end

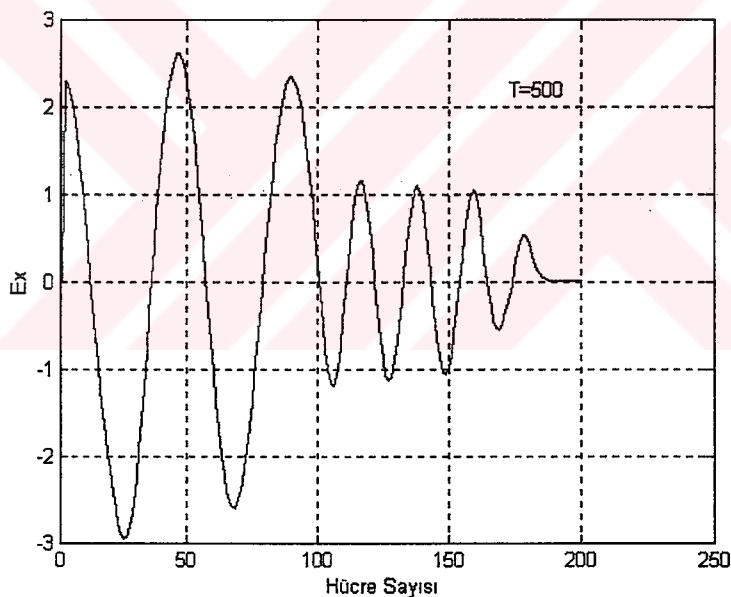
%gauss darbesi
for n=1:Nstep
    T=T+1;
    for k=2:KE
        Ex(k)=ca(k)*Ex(k)+cb(k)*(Hy(k-1)-Hy(k));
    end
    % pulse=sin(2*pi*f*dt*T);
    pulse=exp(-0.5*((to-T)/spread)^2);
    Ex(5)=Ex(5)+pulse;
```

Çizelge 3.2. (devam)

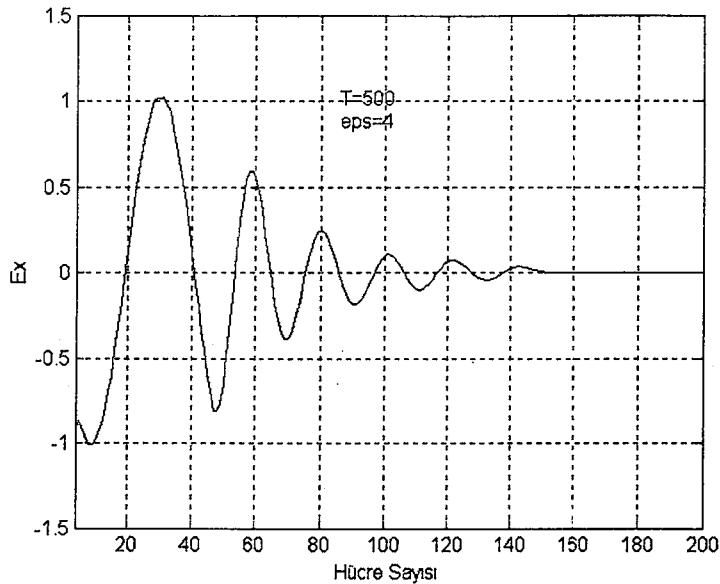
```

for k=2:KE
    Hy(k)=Hy(k)+0.5*(Ex(k)-Ex(k+1));
end
plot(Ex);
xlabel('Hücre Sayısı');
ylabel('Ex');

```



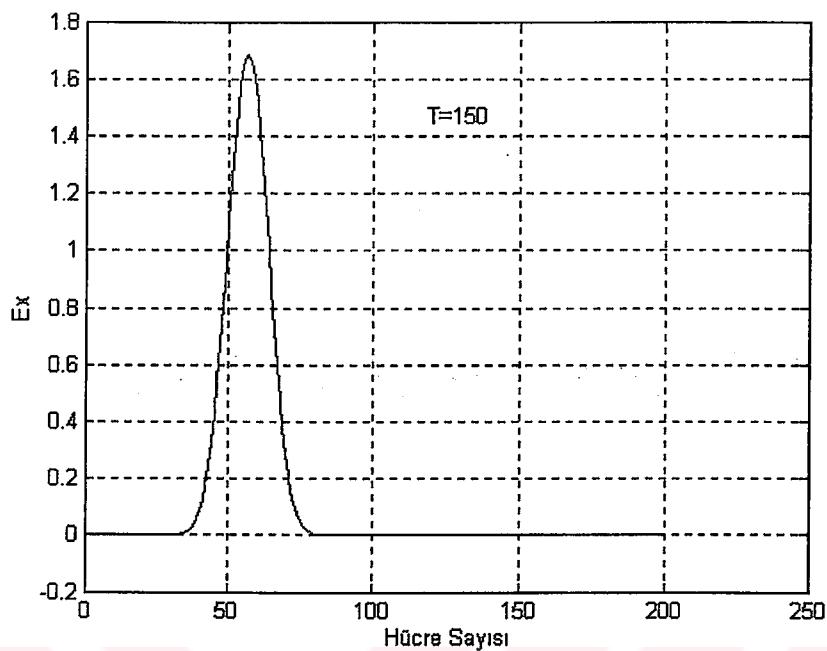
Şekil 3.6 Dielektrik sabiti 4, iletkenliği 0.003(S/m) olan kayıplı bir ortama çarpan sinüzoidal dalganın simülasyonu



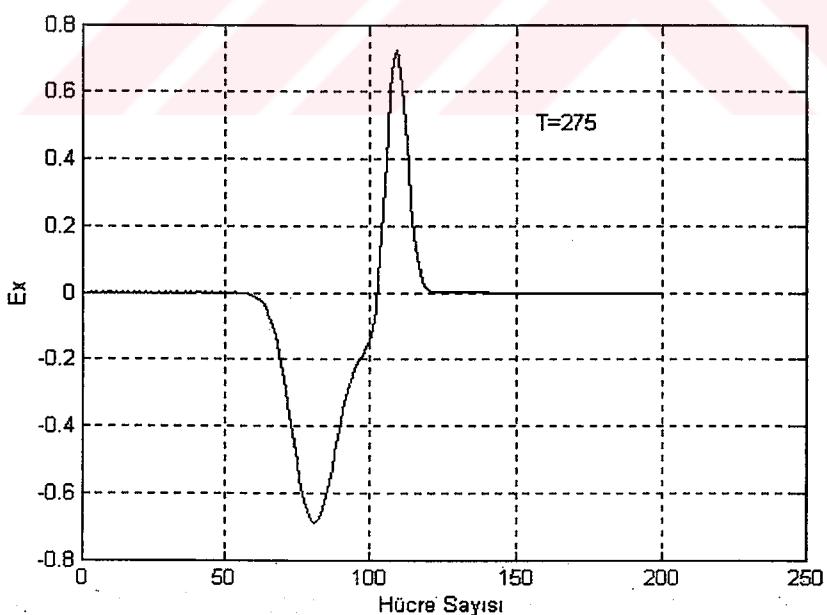
Şekil 3.7 Dielektrik sabiti 4, iletkenliği $0.04(\text{S/m})$ olan kayıplı bir ortama çarpan sinüzoidal dalganın simülasyonu

f1d15.m programı, dielektrik sabiti 4 ve iletkenliği 0.003 olan kayıplı bir ortama çarpan sinüzoidal dalgayı simüle eder. Burada kaynak 700 MHz ' dir ve 5 numaralı hücreye yerleştirilmiştir. Dalga en sol noktada üretilir ve sağa doğru yayılır. Diğer ortama çarptığı hücre 100'üncü hücredir. İkinci ortamın tanımlandığı, başlangıç noktası olan bu hücreye bağlı olarak sonuçlar elde edilir. Sinüzoidal dalga ortama çarpinca bir kısmı geri yansır diğer kısmı ilettilir. İkinci ortamın iletkenlik değerine bağlı olarak dalga sönmeyecektir.

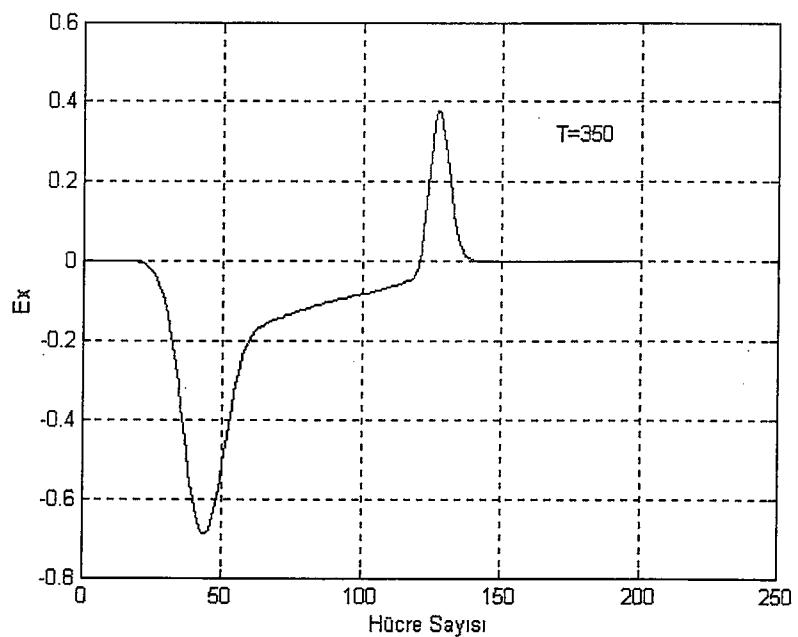
Eğer, kaynak olarak sinüzoidal dalga değil de bir gauss darbesi kullanılırsa aşağıdaki sonuçlar elde edilir. Bu yazılım içinde ortam değişiminin başladığı hücre 100'üncü hücre alınmıştır. Kaynak da yine 5 numaralı hücreye yerleştirilmiştir.



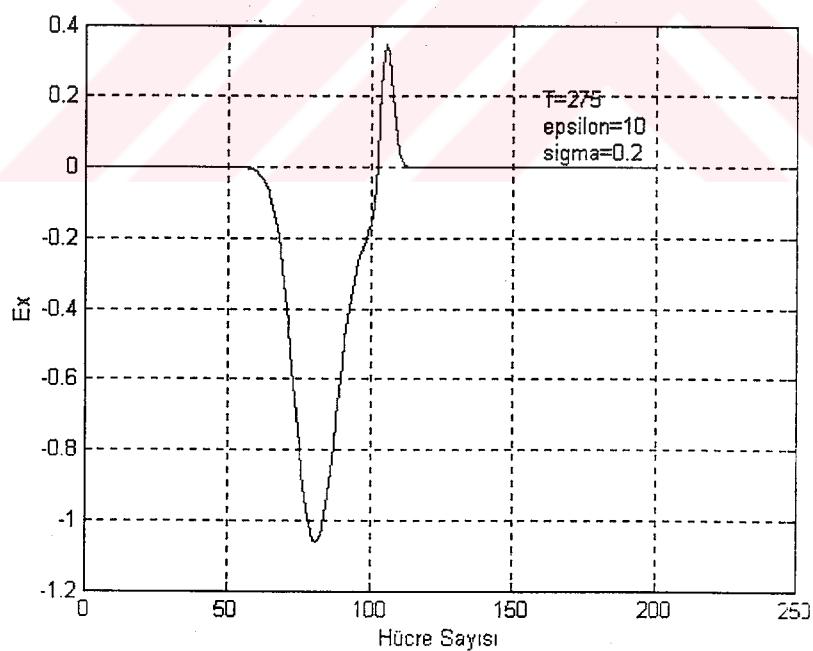
Şekil 3.8 Dielektrik sabiti 4, iletkenliği 0.04(S/m) olan kayıplı bir ortama çarpan Gauss darbesinin simülasyonu ($T=150$)



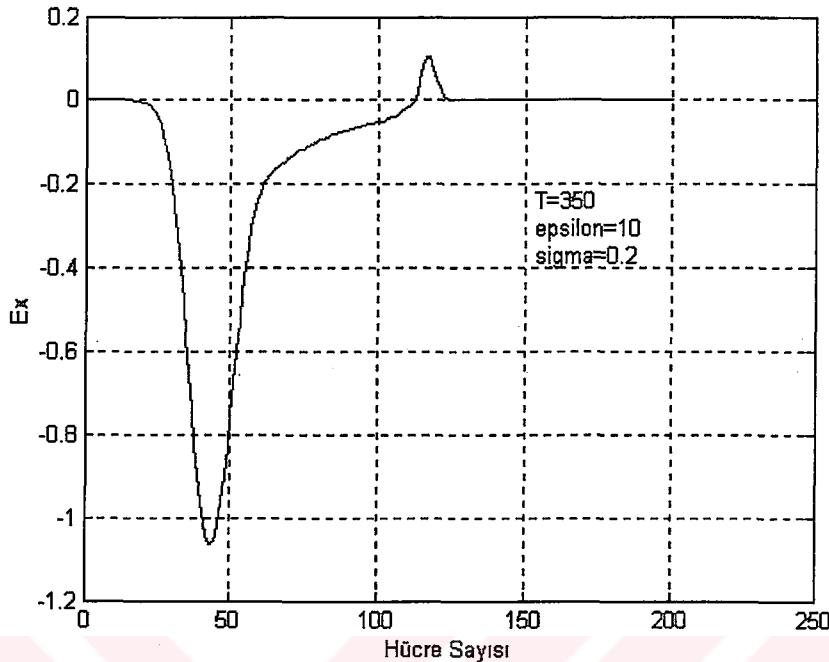
Şekil 3.9 Dielektrik sabiti 4, iletkenliği 0.04(S/m) olan kayıplı bir ortama çarpan Gauss darbesinin simülasyonu ($T=275$)



Şekil 3.10 Dielektrik sabiti 4, iletkenliği 0.04(S/m) olan kayıplı bir ortama çarpan Gauss darbesinin simülasyonu (T=350)



Şekil 3.11 Dielektrik sabiti 10, iletkenliği 0.2 (S/m) olan kayıplı bir ortama çarpan Gauss darbesinin simülasyonu (T=275)



Şekil 3.12 Dielektrik sabiti 10, iletkenliği 0.2 (S/m) olan kayıplı bir ortama çarpan Gauss darbesinin simülasyonu ($T=350$)

Darbe ikinci ortam içerisinde ilerlerken iletkenliğe bağlı olarak genliği azalır. Yansıyan dalganın genliği ise herhangi bir kayıp olmadığından sabit kalır.

3.3 Kullanılan Aki Yoğunluğunun Yeniden Formülasyonu

Maxwell denklemlerinin daha genel bir formu;

$$\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \nabla \times \mathbf{H} \quad (3.12a)$$

$$\mathbf{D}(w) = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r^*(w) \cdot \mathbf{E}(w) \quad (3.12b)$$

$$\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = \frac{-1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{E} \quad (3.12c)$$

şeklindedir (Haznadar ve Stih, 2000).

Burada \mathbf{D} elektrik aki yoğunluğuudur. Dikkat edilmelidir ki 3.12b eşitliği frekans domeninde yazılmıştır. Bu eşitliklerin normalize edilmesiyle,

$$\tilde{E} = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \cdot E \quad (3.13a)$$

$$\tilde{D} = \sqrt{\frac{1}{\epsilon_0 \mu_0}} \cdot D \quad (3.13b)$$

ve bu denklemlerin kullanılmasıyla

$$\frac{\partial \tilde{D}}{\partial t} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \nabla \times H \quad (3.14a)$$

$$\tilde{D}(w) = \epsilon_r^*(w) \cdot \tilde{E}(w) \quad (3.14b)$$

$$\frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \nabla \times \tilde{E} \quad (3.14c)$$

denklemleri elde edilir.

Bölüm 1' de görüldüğü üzere gibi 3.14a ve 3.14b denklemlerinin bu formu, çok basit sonlu fark denklemleri olan 2.11a ve 2.11b denklemlerinin yeniden düzenlenmesine öncülük edecektir. Ancak FDTD içerisinde uygulayabilmek için, 3.14b denklemini, zaman domeni fark denklemi içerisinde elde etmek gerekmektedir. Bunu yapmak için ilk adım frekans domeninden zaman domenine geçiştir. Kayıpsız dielektrik ortamlarla ilgilenirken aşağıdaki form kullanılır (Routhwell and Cloud, 2000).

$$\epsilon_r^*(w) = \epsilon_r + \frac{\sigma}{jw\epsilon_0} \quad (3.15)$$

3.15 denklemi, 3.14b denkleminde yazılırsa,

$$D(w) = \epsilon_r \cdot E(w) + \frac{\sigma}{jw\epsilon_0} E(w) \quad (3.16)$$

elde edilir.

Bu denklemin ilk terimini zaman domeni içerisinde almak önemli bir problem oluşturmamaktadır. Çünkü, bu, basit bir çarpma işlemidir. İkinci terimdeki 1/jw ise Fourier teorisine göre zaman domeninde bir integrasyondur. Yani 3.16 denklemi

olarak yazılabilir.

Buradan örneklenmiş zaman domenine geçilir. Yani integral, Δt zaman aralıklarında bir toplama yaklaştırılır.

$$D^n = \varepsilon_r \cdot E^n + \frac{\sigma \cdot \Delta t}{\varepsilon_0} \sum_{i=0}^n E^i \quad (3.17)$$

Dikkat edilmelidir ki E ve D , $t=n \cdot \Delta t$ zamanında açıkça belirtilmiştir. 3.14b denklemine dönüp baktığımızda kalan tek problem, D^n değerinden E^n değerinin çözülmek zorunda olunmasıdır. Malesef toplam hesabı içerisinde E^n 'e ihtiyaç duyulmaktadır. Bu problem, E^n 'li terimleri toplamdan ayırmak suretiyle çözülür.

$$D^n = \varepsilon_r \cdot E^n + \frac{\sigma \cdot \Delta t}{\varepsilon_0} E^n + \frac{\sigma \cdot \Delta t}{\varepsilon_0} \sum_{i=0}^{n-1} E^i$$

Buradan E^n 'i hesaplanırsa

$$E^n = \frac{D^n - \frac{\sigma \cdot \Delta t}{\varepsilon_0} \sum_{i=0}^{n-1} E^i}{\varepsilon_r + \frac{\sigma \cdot \Delta t}{\varepsilon_0}} \quad (3.18) \text{ bulunur.}$$

E^n (E 'nin mevcut değeri), D 'nin şu anki değeri ve E 'nin daha önceki değerinden hesaplanabilir. Bu, toplam için yeni parametreler tanımlamada avantaj sağlayacaktır.

$$I^n = \frac{\sigma \cdot \Delta t}{\varepsilon_0} \sum_{i=0}^n E^i$$

Yani 3.18 denklemi aşağıdaki şekilde iki yeni denkleme dönüşür.

$$E^n = \frac{D^n - I^{n-1}}{\varepsilon_r + \frac{\sigma \cdot \Delta t}{\varepsilon_0}} \quad (3.19a)$$

$$I^n = I^{n-1} + \frac{\sigma \cdot \Delta t}{\epsilon_0} E^n \quad (3.19b)$$

Buradan görülmektedir ki, 3.19b denklemi, her n zaman adımında E^n değerinin sabit bir terimle çarpılıp, $n-1$ ‘deki toplamın önceki değerlerine eklenmesiyle elde edilir ve toplam bu denklemle hesaplanır. Sıfırdan n' e tüm E^n değerlerinin hesaplanması gereksizdir. Şimdi, tüm FDTD formülasyonu;

$$dx(k) = dx(k) + .5 * (hy(k-1) - hy(k)) \quad (3.20a)$$

$$ex(k) = gax(k) * (dx(k) - ix(k)) \quad (3.20b)$$

$$ix(k) = ix(k) + gbx(k) * ex(k) \quad (3.20c)$$

$$hy(k) = hy(k) + .5 * (ex(k) - ex(k+1)) \quad (3.20d)$$

şeklindedir.

Burada;

$$gax(k) = 1 / (\epsilon_0 + (\sigma * dt / \epsilon_0)) \quad (3.21a)$$

$$gbx(k) = \sigma * dt / \epsilon_0 \quad (3.21b) \quad \text{dir.}$$

Çizelge 3.3. Dielektrik bir ortama çarpan darbenin simülasyon yazılımı

% Dielektrik Bir Ortama Çarpan Darbenin FDTD Simülasyonu (f1d21)

% Aki Yognlugunu Kullanan Yeni Formülasyon

KE=200;

kc=KE/2; %Problem uzayının merkezi

ddx=0.01; %Hücre boyu

dt=ddx/6e8; %Zaman adımı

epso=8.8541878*(10^-12); %Boşluğun dielektrik sabiti

pi=3.14159;

kstart=100;

epsilon=2;

Çizelge 3.3. (devam)

```

sigma=0;
nsteps=300;
%Başlangıç Koşulları
for k=1:KE
    ga(k)=1;
    gb(k)=0;
    ex(k)=0;
    dx(k)=0;
    hy(k)=0;
    ix(k)=0;
end

for k=kstart:KE
    ga(k)=(1/(epsilon+sigma*(dt/epso)));
    gb(k)=sigma*(dt/epso);
end

%Giris Darbesini Belirleyen Parametreler
to=40.0;
w=12.0;%spread
T=0;

for n=1:nsteps
    T=T+1;
    %Dx'in Hesabi
    for k=2:KE
        dx(k)=dx(k)+0.5*(hy(k-1)-hy(k));
    end

```

Çizelge 3.3. (devam)

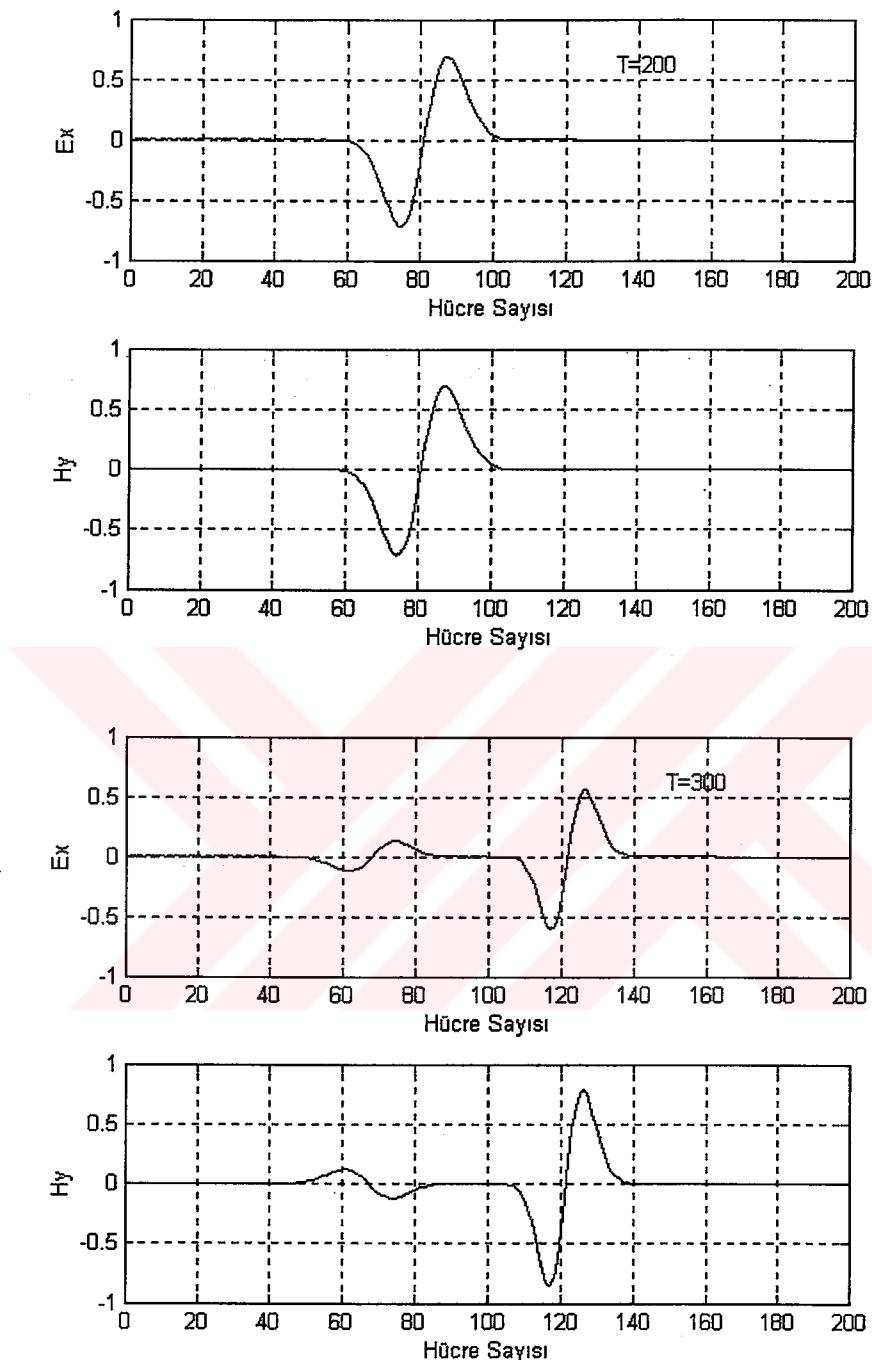
```
%Gauss Darbesinin Yerleştirilmesi
freq_in=700e6;
%pulse=sin(2*pi*freq_in*dt*T);
pulse=exp(-0.5*((to-T)/w)^2);
dx(5)=dx(5)+pulse;

%Dx den Ex'in Hesabi
for k=1:KE-1
    ex(k)=ga(k)*(dx(k)-ix(k));
    ix(k)=ix(k)+gb(k)*ex(k);
end

%Hy ALANININ HESABI

for k=1:KE-1
    hy(k)=hy(k)+0.5*(ex(k)-ex(k+1));
end
display(ex);
subplot(2,1,1);
plot(ex);
xlabel('Hücre Sayısı');
ylabel('Ex');

subplot(2,1,2);
plot(hy);
xlabel('Hücre Sayısı');
ylabel('Hy');
```



Şekil 3.13 $T=200$ ve $T=300$ için dielektrik bir ortama çarpan darbenin simülasyonu

Buradaki önemli nokta, eşitlik 3.20b ve 3.20c kodlarının ortama bağlı tüm bilgileri içermesidir. Serbest uzay için $gax=1$ ve $gbx=0$ ‘dır. Kayıplı malzemeler için gax ve gbx , 3.21a ve 3.21b eşitlikleriyle hesaplanır. k noktasında $ex(k)$ ‘nın hesaplanmasında sadece, $ex(k)$ ‘nın önceki değeriyle $dx(k)$ değeri kullanılır. İlk bölümdeki

formüllerle karşılaştırdığımızda burada daha karmaşık bir yapı görülmektedir. Artık E_x kadar, D_x 'e ve bir yardımcı parametre olan i_x ' e ihtiyaç duyulmaktadır. Daha kompleks malzemelerle uğraşıldığında, karmaşıklığın azaltılmasında i_x ' in gerçek avantajı ortaya çıkacaktır.

3.4 Frekans Domeni Çıkış Hesabı

Değişik frekanslara bağlı olarak, dielektrik bir ortam için her noktada E alanı hesaplanmak istenirse ortamda, ilgilenilen her noktada sonuca, genlik ve faz belirleninceye ve durgun duruma ulaşılıncaya kadar FDTD programının tekrarı yapılarak ulaşılabilir. Sistem teorisine göre eğer kaynak olarak bir darbe kullanılırsa, her bir frekansın tepkisi elde edilebilir. Gaussian dağılımına göre, eğer dağılım yeterince dar ise iyi bir impulsa yaklaşılır. Daha sonra darbe sönünceye kadar FDTD programı tekrarlanır ve E alanının Fourier dönüşümünü elde edilir. Eğer bir noktadaki E alanının Fourier dönüşümü biliniyorsa, herhangi bir sinüzoidal kaynak ile oluşan E alanının, fazı ve genliği hesaplanabilir. İlgilenilen her noktada, zaman domeni verilerinin tümü için, E alanının, FDTD program tekrarlanıncaya yani verinin Fourier dönüşümü, tahmin edilir bir FFT kullanılarak hesaplanıncaya kadar depolanmak zorunda olması mantıksal bir zorluk ortaya çıkarır (Taflove, 1995).

Buna alternatif bir çözüm gerekmektedir. f_1 frekansında $E(t)$ alanının Fourier dönüşümünü hesaplanmak istenildiğinde bu;

$$E(f_1) = \int_0^{t_T} E(t) \cdot e^{-j2\pi f_1 t} dt \quad (3.22)$$

denklemiyle yapılabilir.

Burada, FDTD program, tüm fonksiyonları nedensel fonksiyon varsayığı için alt sınır sıfırdır. Üst sınır t_T , FDTD iterasyonunun duraklama zamanıdır. 3.22' i sonlu farklar formunda yeniden yazarsak,

$$E(f_1) = \sum_{n=0}^{T/\Delta t} E(n \cdot \Delta t) \cdot e^{-j2\pi f_1 (n \cdot \Delta t)} \Delta t \quad (3.23)$$

denklemi elde edilir (Kunz ve Luebbers, 1993).

T iterasyon sayısı ve Δt zaman adımıdır. Yani $t_T = T \cdot \Delta t$ ‘dir. 3.23 eşitliği gerçek ve sanal kısımlarına ayrılabilir.

$$E(f_i) = \sum_{n=0}^T E(n \cdot \Delta t) \cdot \cos(2\pi f_i \cdot \Delta t \cdot n) - j \sum_{n=0}^T E(n \cdot \Delta t) \cdot \sin(2\pi f_i \cdot \Delta t \cdot n) \quad (3.24)$$

Bu bilgisayar kodıyla,

$$\text{realpt}(m, k) = \text{realpt}(m, k) + ex(k) * \cos(2 * pi * freq(m) * dt * n) \quad (3.25a)$$

$$\text{imagpt}(m, k) = \text{imagpt}(m, k) + ex(k) * \sin(2 * pi * freq(m) * dt * n) \quad (3.25b)$$

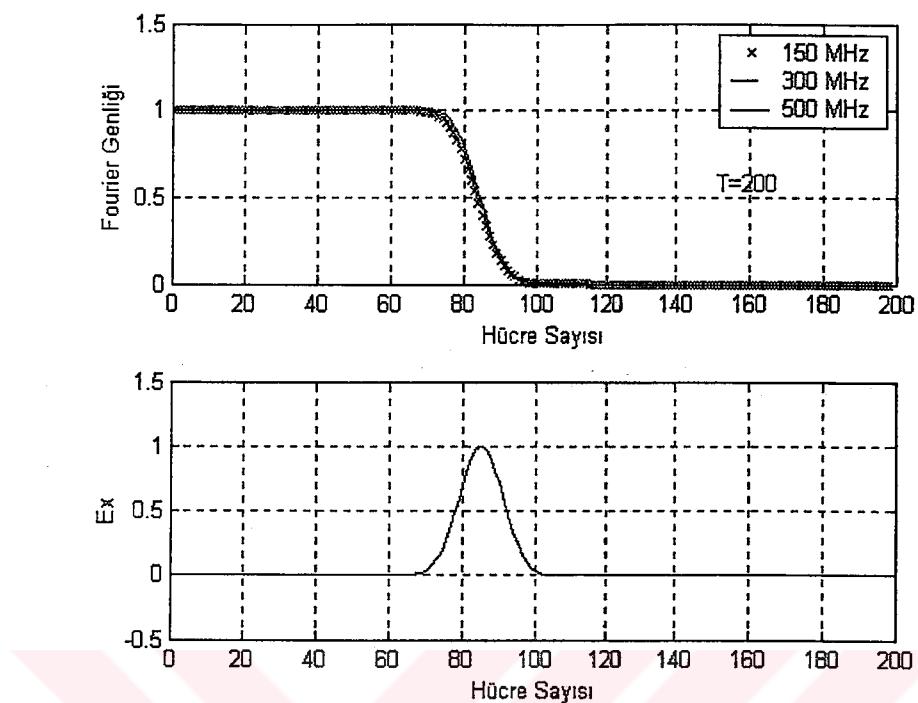
şeklinde belirtilir.

Çözüm bölgesinde, her k noktasında, ilgilenilen her f_m frekansı için sadece iki değişkene gereksinim vardır. Herhangi bir k noktasında $E(f_i)$ ’nin reel kısmı $\text{realpt}(m, k)$ ve sanal parçası $\text{imagpt}(m, k)$ kullanılarak f_m frekansındaki genlik ve faz hesaplanabilir.

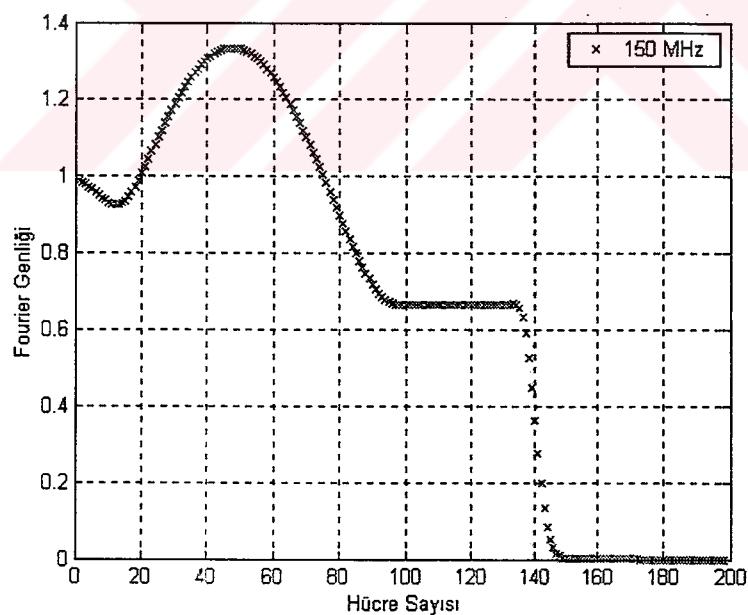
$$\text{amp}(m, k) = \sqrt{\text{pow}(\text{realpt}(m, k), 2.) + \text{pow}(\text{imagpt}(m, k), 2.))} \quad (3.26a)$$

$$\text{phase}(m, k) = \text{atan2}(\text{imagpt}(m, k), \text{realpt}(m, k)) \quad (3.26b)$$

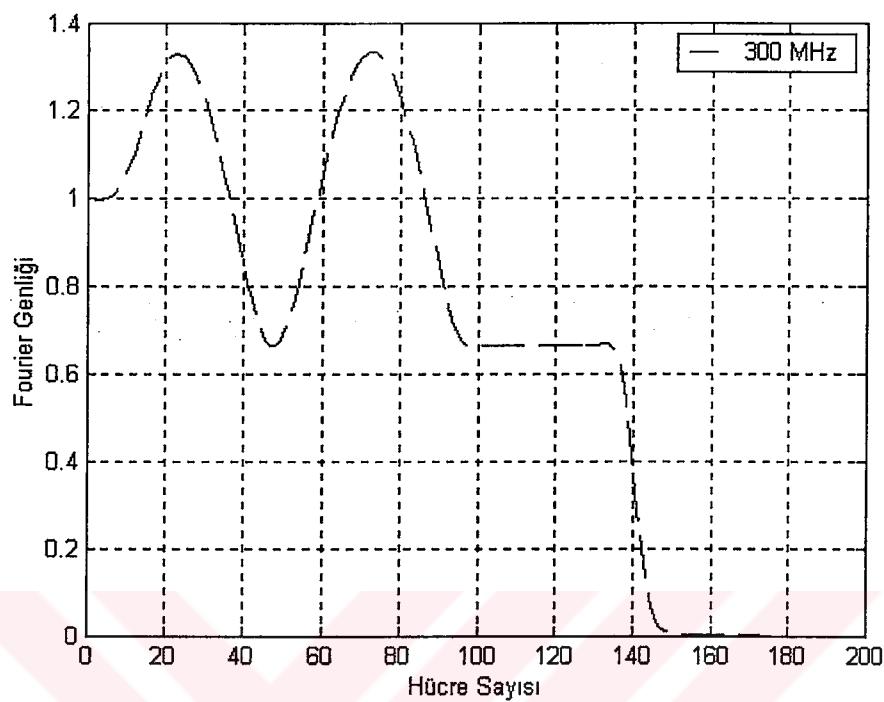
Dikkat edilmelidir ki buradaki genlik ve faz, her bir hücre için, her bir frekansla birleştirilen genlik ve faz değerleridir. Çizelge 3.2. (f1d21.m programı) içerisinde yukarıdaki kodların yerleştirilmesiyle, problem uzayı boyunca 3 frekanstaki frekans tepkisini hesaplanabilir.



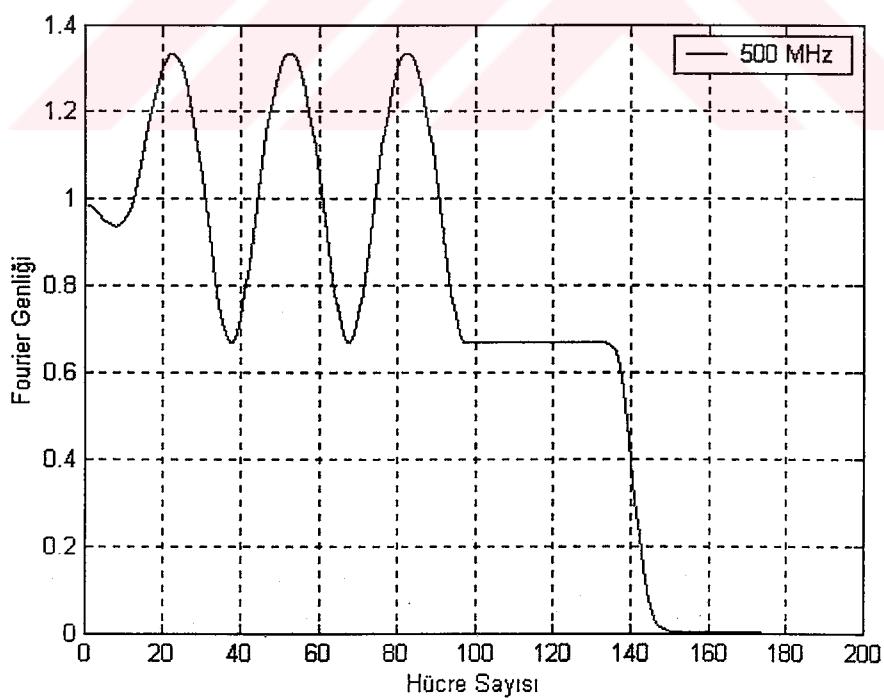
Şekil 3.14 $T=200$ de, darbe ortama çarpmadan önce frekans tepkisi ve elektrik alan



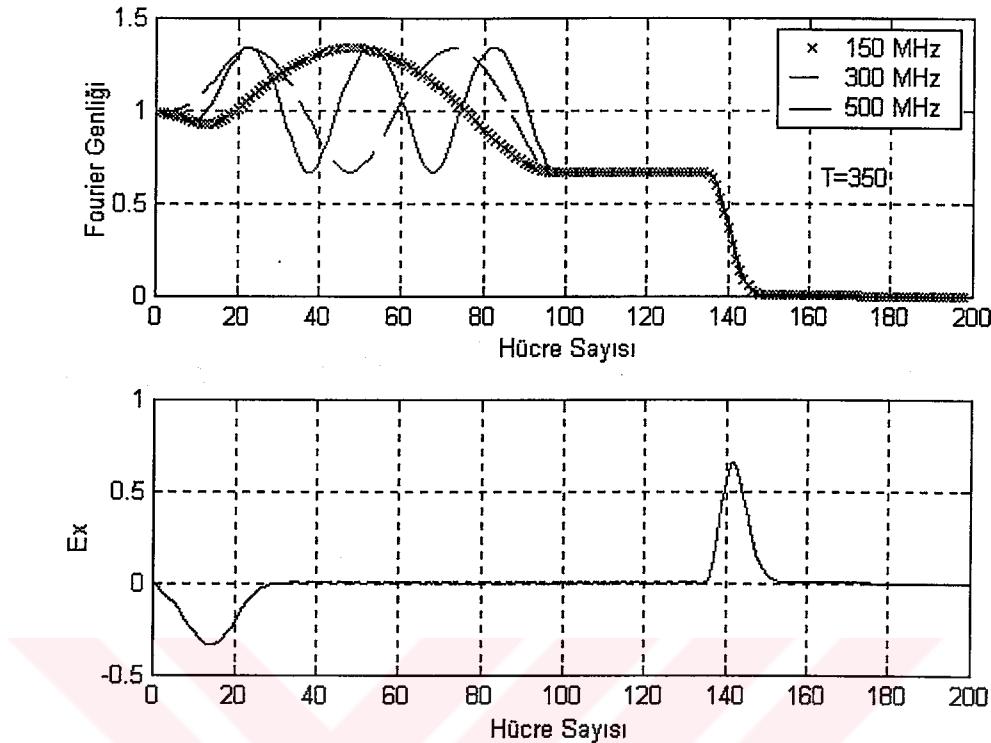
Şekil 3.15. $T=350$ de, darbe ortama çarptıktan sonra Fourier genliği ($f = 150 \text{ MHz}$)



Şekil 3.16. $T=350$ de, darbe ortama çarptıktan sonra fourier genliği ($f=300$ MHz)



Şekil 3.17. $T=350$ de, darbe ortama çarptıktan sonra fourier genliği ($f=500$ MHz)



Şekil 3.18. T=350 de, darbe ortama çaptıktan sonra frekans tepkisi ve elektrik alan

Yansıyan ve iletilen darbenin genliği;

$$\Gamma = \frac{E_{ref}}{E_{inc}} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} \quad (3.27)$$

$$\tau = \frac{E_{trans}}{E_{inc}} = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} \quad (3.28)$$

$$\text{Empedans } \eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon_0 \epsilon_r^*}}$$

$$\epsilon_r^* = \epsilon_r + \frac{\sigma}{jw\epsilon_0}$$

$\mu = \mu_0$ olması durumunda

$$\Gamma = \frac{\frac{1}{\sqrt{\epsilon_2^*}} - \frac{1}{\sqrt{\epsilon_1^*}}}{\frac{1}{\sqrt{\epsilon_2^*}} + \frac{1}{\sqrt{\epsilon_1^*}}} = \frac{\sqrt{\epsilon_1^*} - \sqrt{\epsilon_2^*}}{\sqrt{\epsilon_1^*} + \sqrt{\epsilon_2^*}}$$

$$\tau = \frac{2/\sqrt{\epsilon_2^*}}{\frac{1}{\sqrt{\epsilon_2^*}} + \frac{1}{\sqrt{\epsilon_1^*}}} = \frac{2 \cdot \sqrt{\epsilon_1^*}}{\sqrt{\epsilon_1^*} + \sqrt{\epsilon_2^*}}$$

denklemleriyle hesaplanır (Balanis 1989).

$$\tau = \frac{\sqrt{1 \cdot 2}}{1 + \sqrt{4}} = .667 \quad \tau = \frac{1 - \sqrt{4}}{1 + \sqrt{4}} = 0.333$$

FDTD çözümüyle ulaştığımız simülasyon sonuçları ve analitik çözümler arasında tam bir uyum olduğu görülmektedir (Bkz. Şekil 3.18.)

3.5 Frekansa Bağlı Ortamlar

Ortamların dielektrik sabitleri ve iletkenlikleri frekansa bağlılık gösterir. Bölüm 1 ve Bölüm 2 de kaynak olarak kullanılan darbeler bir frekans spektrumu içerirler. Dolayısıyla frekansa bağlı malzemeyi simüle edebilmek için bir analize ihtiyaç duyulmaktadır. FDTD metodundaki başarılı gelişmelerden biri frekansa bağlı malzemelerin simüle edilmesidir.

Örneğin, 10 MHz-1000 MHz frekans aralığında dielektrik sabiti ve iletkenliği değişen bir ortam için gerekli denklemler aşağıdaki gibi yeniden düzenlenlenebilir.

$$\epsilon_r^*(w) = \epsilon_r + \frac{\sigma}{jw\epsilon_0} + \frac{\chi_1}{1 + jw t_0} \quad (3.29)$$

Bu eşitlik Debye formülünü işaret eder (Kunz ve Luebbers, 1993). Bu formülde dielektrik sabiti ϵ_r ve iletkenlik σ 'nın yanında frekansa bağlı birde terim vardır. Aşağıdaki parametreler şekil 3.3'ün ortamı için verilmiştir.

$$\epsilon_r = 2 \quad \sigma = 0.01 \quad X_1 = 2 \quad t_0 = 0.001 \mu s$$

FDTD'de bu ortamın simülasyonunu gerçekleştirmek için, 3.29 denklemi, örneklenmiş zaman domeni içerisinde konulmalıdır. Son terimle elektriksel alanın çarpımı,

$$S(w) = \frac{\chi_1}{1 + jw t_0} E(w) \quad (3.30)$$

şeklinde tanımlanabilir.

Debye teriminin ters Fourier dönüşümü $(X_1/t_0)e^{-(t/t_0)} u(t)$ şeklindedir (Kunz ve Luebbers, 1993). Burada $u(t)$, $t < 0$ için 0 ve daha sonra 1 olan dikdörtgensel fonksiyondur (Hazırlanan yazılım başlangıç alan değerlerini sıfır olarak kabul ettiği için FDTD 'nin tüm fonksiyonları nedensel olarak aldığı hatırlanmalıdır). Frekans domenindeki 3.30 denklemi, zaman domeninde konvolüsyon olur.

$$S(t) = \frac{\chi_1}{t_0} \int_0^t e^{-(t'-t)/t_0} E(t') \cdot dt'$$

Bu denklem örneklenmiş zaman domeninde bir toplama yaklaştırılırsa,

$$S^n = \chi_1 \cdot \frac{\Delta t}{t_0} \sum_{i=0}^n e^{-\Delta t(n-i)/t_0} \cdot E^i = \chi_1 \cdot \frac{\Delta t}{t_0} (E^n + \sum_{i=0}^{n-1} e^{-\Delta t(n-i)/t_0} \cdot E^i) \quad (3.31)$$

elde edilir.

Burada

$$S^{n-1} = \chi_1 \cdot \frac{\Delta t}{t_0} \sum_{i=0}^{n-1} e^{-\Delta t(n-1-i)/t_0} \cdot E^i = \chi_1 \cdot \frac{\Delta t}{t_0} e^{\Delta t/t_0} \sum_{i=0}^{n-1} e^{-\Delta t(n-i)/t_0} \cdot E^i$$

olduğuna dikkat edilmelidir.

Bu denklem 3.31 de yazılrsa,

$$S^n = \chi_1 \cdot \frac{\Delta t}{t_0} \cdot E^n + e^{-\Delta t/t_0} S^{n-1} \quad (3.32)$$

olmaktadır.

Benzer yolla kayıplı dielektrik ortamlar için,

$$D^n = \epsilon_r \cdot E^n + I^n + S^n$$

$$D^n = \epsilon_r \cdot E^n + \left[\frac{\sigma \cdot \Delta t}{\epsilon_0} \cdot E^n + I^{n-1} \right] + \left[\chi_1 \cdot \frac{\Delta t}{t_0} \cdot E^n + e^{-\Delta t/t_0} \cdot S^{n-1} \right] \quad (3.33)$$

olarak yazılabılır.

E^n için çözüm,

$$E^n = \frac{D^n - I^{n-1} - e^{-\Delta t/t_0} S^{n-1}}{\epsilon_r + \frac{\sigma \cdot \Delta t}{t_0} + \chi_1 \cdot \frac{\Delta t}{t_0}} \quad (3.34a)$$

$$I^n = I^{n-1} + \frac{\sigma \cdot \Delta t}{t_0} \cdot E^n \quad (3.34b)$$

$$S^n = e^{-\Delta t/t_0} S^{n-1} + \chi_1 \cdot \frac{\Delta t}{t_0} \cdot E^n \quad (3.34c)$$

denklemleriyle elde edilir.

3.5.1 Yardımcı Diferansiyel Eşitlik Metodu

3.29 denklemi ile tanımlanan dispersive ortamların simülasyonu için, farklı bir yaklaşım kullanılabilir. Buradaki metot yardımcı diferansiyel eşitlik metodu (YDE) olarak adlandırılır. 3.30 denklemini aşağıdaki şekilde yeniden yazabiliriz.

$$(1 + j\omega t_0)S(w) = \chi_1 E(w) \quad (3.35)$$

Yeniden FDTD formülasyonunda işlem yapabilmek, dolayısıyla ayrık zaman domenine geçmek için bir yönteme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreçte sürekli zaman domenine geçişle başlanabilir. Yani 3.35 denklemi,

$$s(t) + t_0 \frac{ds(t)}{dt} = \chi_1 e(t) \quad (3.36)$$

şeklinde yazılabılır. Bu ifade örneklenmiş zaman domeninde,

$$\frac{S^n + S^{n-1}}{2} + t_0 \frac{S^n - S^{n-1}}{\Delta t} = \chi_1 E^n \quad \text{olarak ifade edilir.}$$

Dikkat edilmelidir ki n ve $(n-1)$ zaman adımlarında, yani 2 zaman adımı içerisinde $s(t)$ terimine yaklaşılmıştır. Böyle bir türetmede, S^n çözülürse,

$$S^n = \frac{\left(1 - \frac{\Delta t}{2 \cdot t_0}\right) S^{n-1} + \left(\frac{\Delta t}{t_0}\right) \cdot \chi_1 \cdot E^n}{\left(1 + \frac{\Delta t}{2 \cdot t_0}\right)} \quad (3.37)$$

eşitliği elde edilir.

3.34 denklemindeki E^d ‘i hesaplamak için 3.32 denklemi yerine 3.37 denklemi kullanılabilir. Bunun eşdeğer bir çözümü vereceğinden bazı yaklaşımalarla emin olmak mümkündür.

$$1 - \delta \approx e^{-\delta} \quad \delta \ll 1 \text{ ise}$$

$$\frac{1}{1 + \delta} \approx e^{-\delta} \quad \delta \ll 1 \text{ ise}$$

İkisi birlikte ele alındığında:

$$\frac{1 - \delta}{1 + \delta} \approx e^{-2\delta} \quad \delta \ll 1 \text{ ise}$$

Bu durumda,

$$\begin{aligned} \delta &= \frac{\Delta t}{2 \cdot t_0} \\ \frac{(1 - \frac{\Delta t}{2 \cdot t_0})}{(1 + \frac{\Delta t}{2 \cdot t_0})} &\approx e^{-\Delta t / t_0} \end{aligned} \tag{3.38}$$

elde edilir.

Bu yaklaşım sadece şu sorunun yanıtlanması sağlanacaktır. $\Delta t / t_0$ ‘ın yeterince küçük olduğu nasıl bilinmektedir? Simülasyonda, en küçük dalga boyunda, dalga boyu başına yaklaşık on nokta elde edebilmek için, hücre boyutu yeterince küçük olmalıdır. Bu da benzer bir durumdur. Simüle edilmek istenen ortam t_0 zaman sabitli Debye terimine sahipse, zaman adımlarımızı t_0 ile karşılaştırıldığımızda küçüktür ve $\Delta t \leq t_0/10$ ‘dur (Kunz ve Luebbers, 1993). Bu 3.38 denkleminin oldukça iyi bir yaklaşım olduğunu ispatlar.

3.5.2 z - Dönüşümü Kullanılarak Formülasyon

Debye ortamında E 'nin hesaplanması problemine geri dönerek, frekans domenini eşitliği;

$$D(w) = (\varepsilon_r + \frac{\sigma}{jw\varepsilon_0} + \frac{\chi_1}{1+jwt_0}) \cdot E(w) \quad \text{şeklinde yazılır.}$$

z -domenine geçildiğinde, zaman domenindeki zahmetli konvolüsyon integralleri ile uğraşmaktan kaçınılabilir.

$$D(z) = \varepsilon_r \cdot E(z) + \frac{\sigma \cdot \Delta t / \varepsilon_0}{1-z^{-1}} \cdot E(z) + \frac{\chi_1 \cdot \Delta t / t_0}{1+z^{-1}} \cdot E(z) \quad (3.39)$$

Dikkat edilirse zaman domeninden z domenine geçişte, son iki terime Δt zaman adımı eklenildi.

Yukarıdaki işlemlere benzer olarak burada bazı yardımcı parametreler tanımlanır.

$$I(z) = \frac{\sigma \cdot \Delta t / \varepsilon_0}{1-z^{-1}} \cdot E(z) = z^{-1}I(z) + \frac{\sigma \cdot \Delta t}{\varepsilon_0} E(z) \quad (3.40a)$$

$$S(z) = \frac{\chi_1 \cdot \Delta t / t_0}{1-e^{-\Delta t / t_0} z^{-1}} \cdot E(z) = e^{-\Delta t / t_0} z^{-1}S(z) + \frac{\chi_1 \cdot \Delta t}{t_0} E(z) \quad (3.40b)$$

3.39 denklemi,

$$D(z) = \varepsilon_r \cdot E(z) + z^{-1}I(z) + \frac{\sigma \cdot \Delta t}{\varepsilon_0} E(z) + e^{-\Delta t / t_0} z^{-1}S(z) + \frac{\chi_1 \cdot \Delta t}{t_0} E(z) \quad (3.41)$$

olur.

$E(z)$ çözüldüğünde,

$$E(z) = \frac{D(z) - z^{-1}I(z) - e^{-\Delta t / t_0} z^{-1}S(z)}{\varepsilon_r + \frac{\sigma \cdot \Delta t}{\varepsilon_0} + \frac{\chi_1 \cdot \Delta t}{t_0}} \quad (3.42)$$

Burada z dönüşümünün avantajı görülmektedir. $E(z)$ yerine E^n , $z^{-1}E(z)$ yerine E^{n-1} yazılabilir ve 3.42, 3.40a ve 3.40b denklemleri de benzer şekilde yenilenebilir.

$$E^n = \frac{D^n - I^{n-1} - e^{-\Delta t/t_0} S^{n-1}}{\epsilon_r + \frac{\sigma \cdot \Delta t}{\epsilon_0} + \frac{\chi_1 \cdot \Delta t}{t_0}} \quad (3.43a)$$

$$I^n = I^{n-1} + \frac{\sigma \cdot \Delta t}{\epsilon_0} E^n \quad (3.43b)$$

$$S^n = e^{-\Delta t/t_0} S^{n-1} + \frac{\chi_1 \cdot \Delta t}{t_0} E^n \quad (3.43c)$$

Bu bölümde elde edilen denklemler, önceki bölümlerde elde edilenlerle tamamıyla aynıdır. Fark, integral ve onların yaklaşımları ile ilgili hiçbir işlem yapmak zorunda kalınmamasıdır. Böylece daha karmaşık fonksiyonlar kullanıldığında yapılacak işlemler basitleşir.

Her üç çözüm metodu sonucunda da aynı denklemler elde edilir. Bu denklemlerin bilgisayar koduyla yazılımı,

$$dx(k) = dx(k) + .5 * (hy(k-1) - hy(k)) \quad (3.44a)$$

$$ex(k) = gax(k) * (dx(k) - ix(k) - del_exp * sx(k)) \quad (3.44b)$$

$$ix(k) = ix(k) + gbx(k) * ex(k) \quad (3.44c)$$

$$sx(k) = del_exp * sx(k) + gcx(k) * ex(k) \quad (3.44d)$$

$$hy(k) = hy(k) + .5 * (ex(k) - ex(k+1)) \quad (3.44e)$$

şeklindedir. Burada,

$$gax(k) = 1 / (epsr + (sigma * dt / epsz) + (chil * dt / t0)) \quad (3.45a)$$

$$gbx(k) = sigma * dt / epsz \quad (3.45b)$$

$$gcx(k) = chil * dt / t0 \quad (3.45c)$$

ve

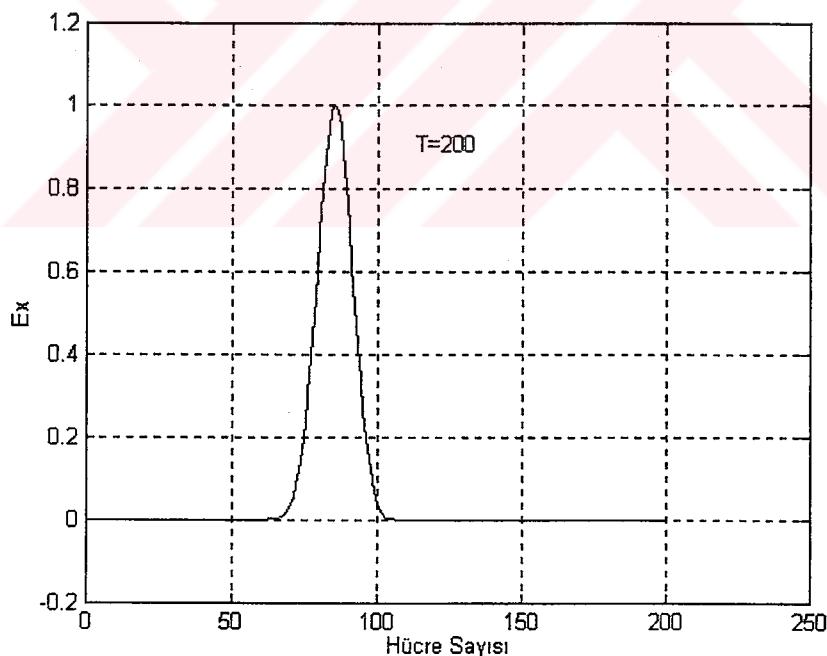
$$delexp = exp(-dt / t0) \quad \text{'dir.}$$

3.44d kodu içerisinde 3.44b' in kullanılması ile elde edilecek denklem, ortamla ilgili bütün parametreleri içerecektir. Akı yoğunluğu ve manyetik alan 3.44a ve 3.44e kodları ile hesaplanır.

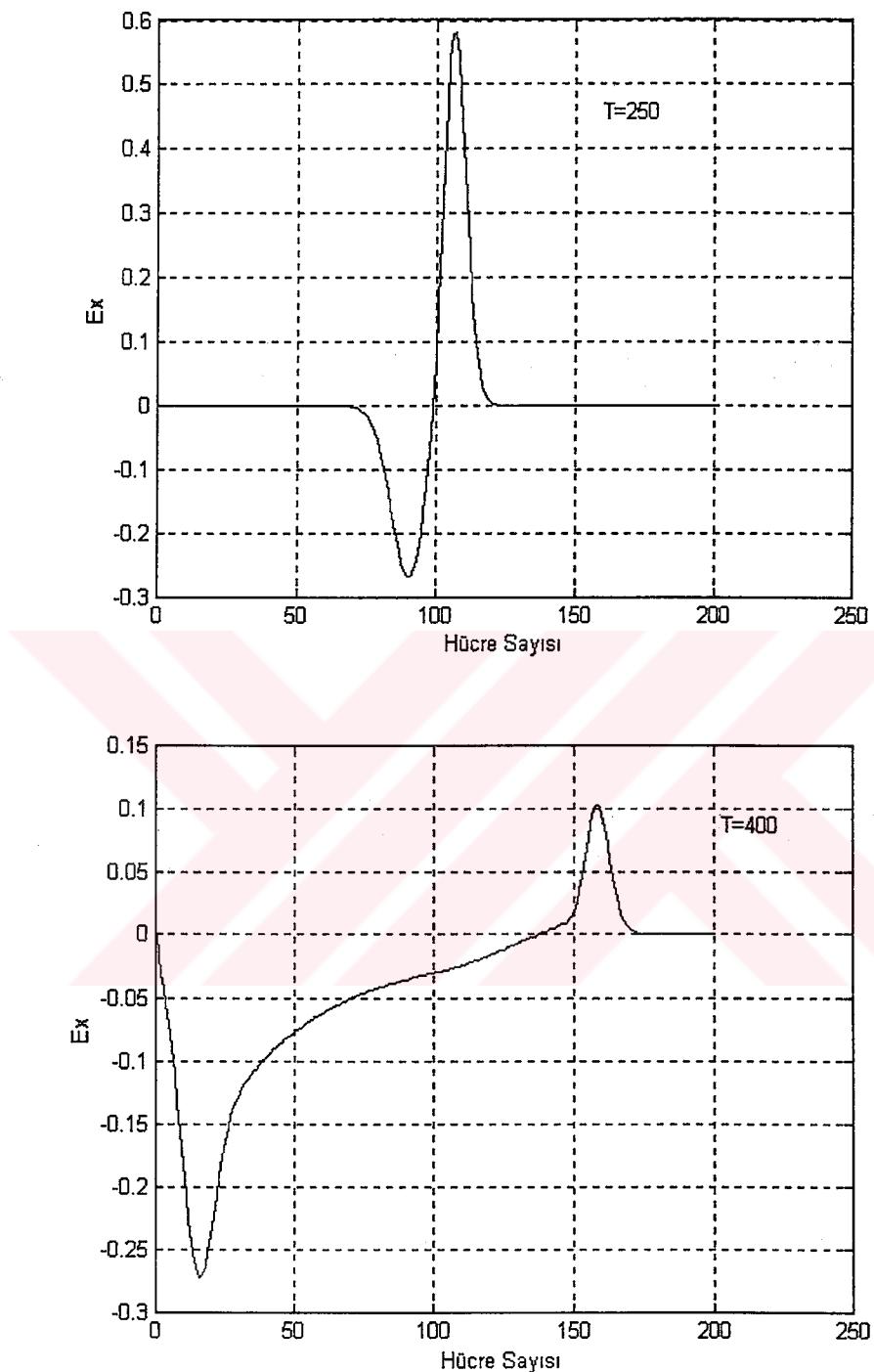
$\epsilon_r = 2$, $\sigma = 0.01$, $X_1 = 2$, $t_0 = 0.001 \mu\text{s}$ özelliklerine sahip frekansa bağlı dielektrik bir malzeme içerisinde giren darbenin simülasyonunda kullanılan, 3 ayrı frekans için parametrelerin değişimi Tablo 3.1'de verilmiştir

Çizelge 3.4. Ortam parametreler dizisi

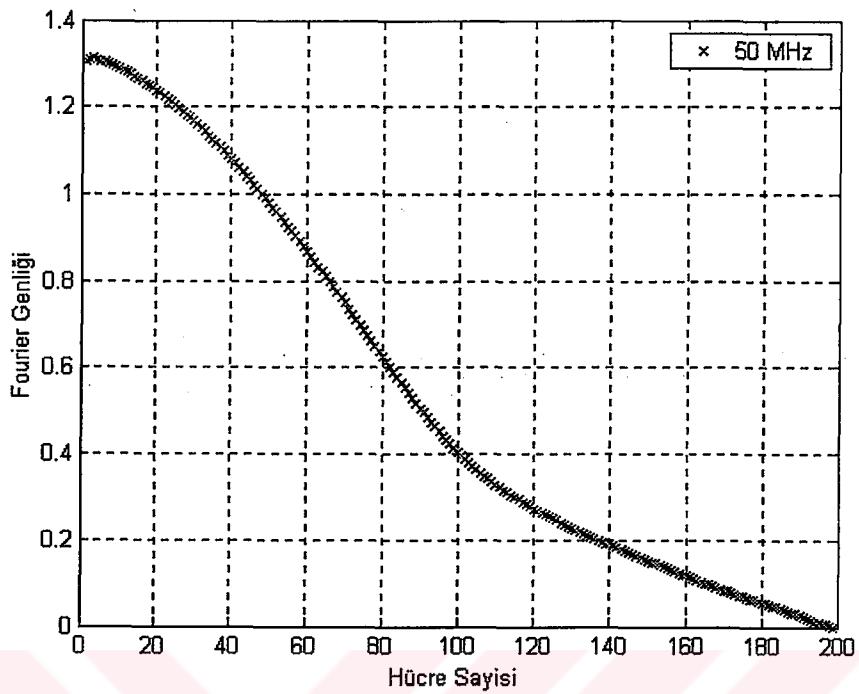
Frekans (MHz)	ϵ_r	$\sigma(\text{S/m})$
50	6.55	.024
200	3.94	.047
500	2.46	.060



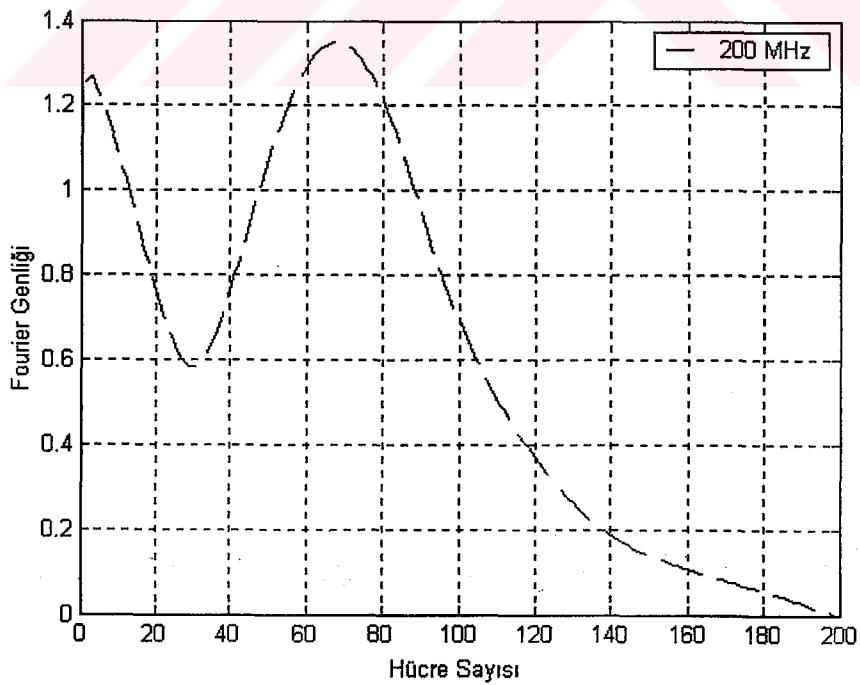
Şekil 3.19. $T=200$ için elektrik alan değeri



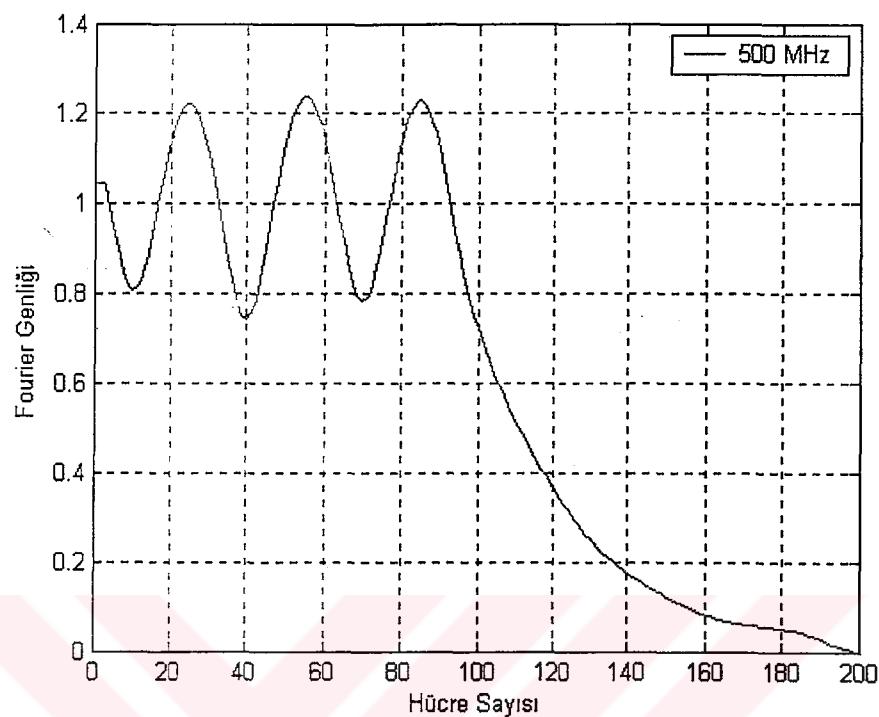
Şekil 3.20. $T=250$ ve $T=400$ için elektrik alan değerleri



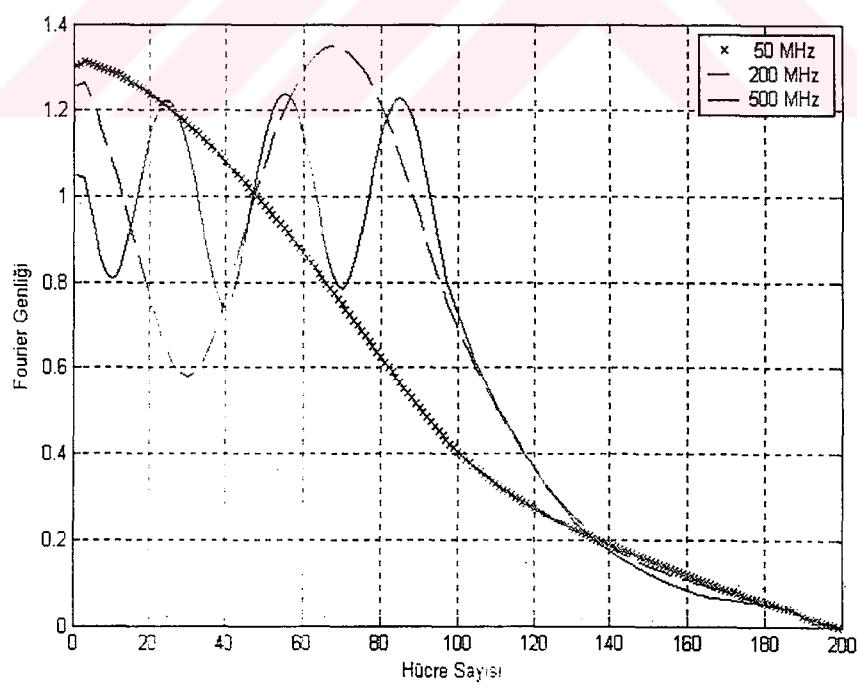
Şekil 3.21. 50 MHz için frekansa bağlı Fourier genliği değişimi (nsteps=500)



Şekil 3.22. 200 MHz için frekansa bağlı Fourier genliği değişimi (nsteps=500)

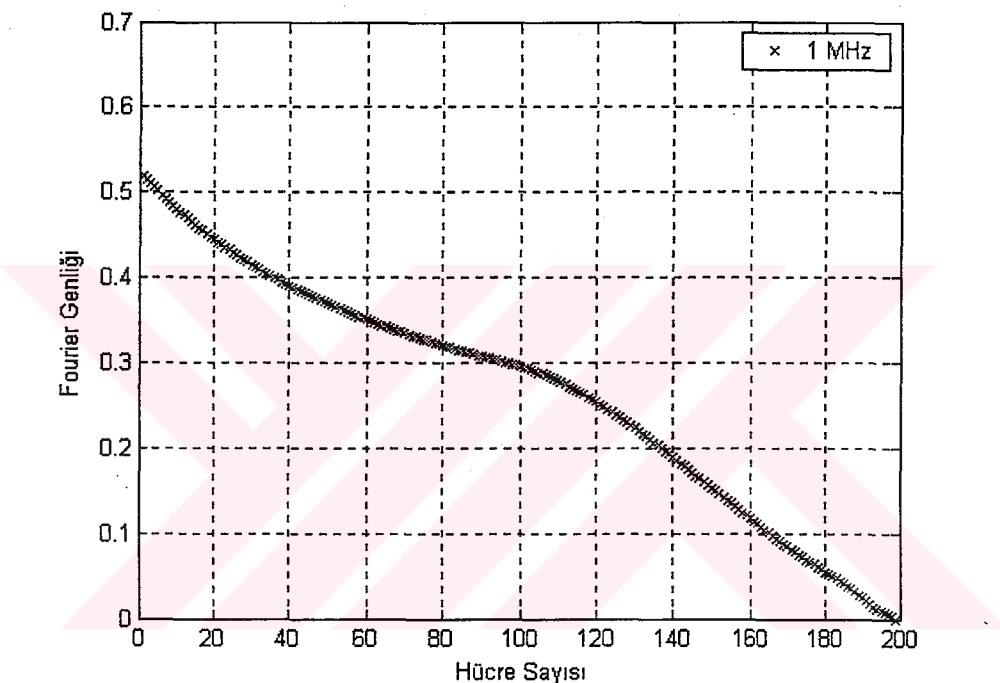


Şekil 3.23. 500 MHz için frekansa bağlı Fourier genliği değişimi (nsteps=500)

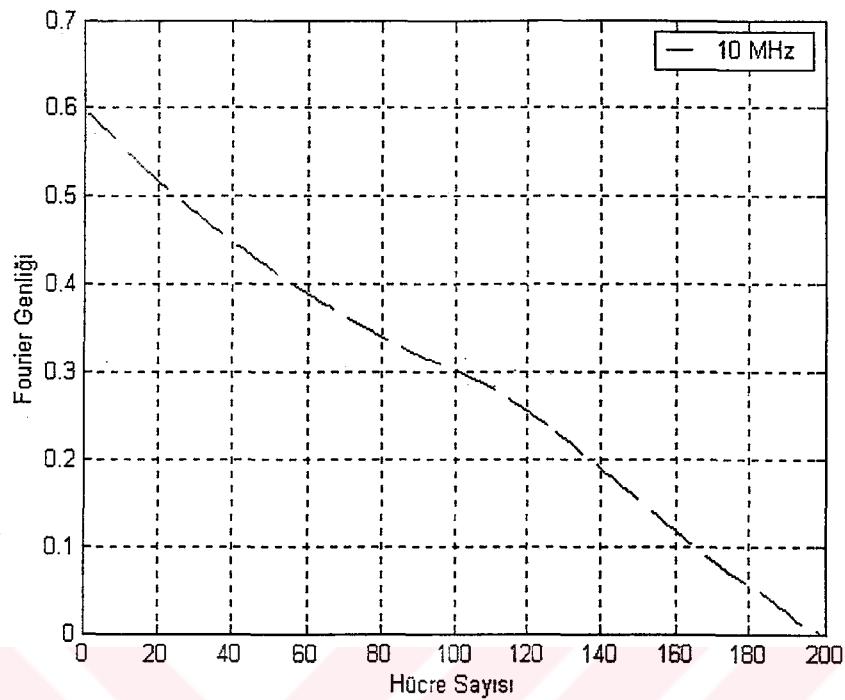


Şekil 3.24. Fourier genliği değişimi (nsteps=500)

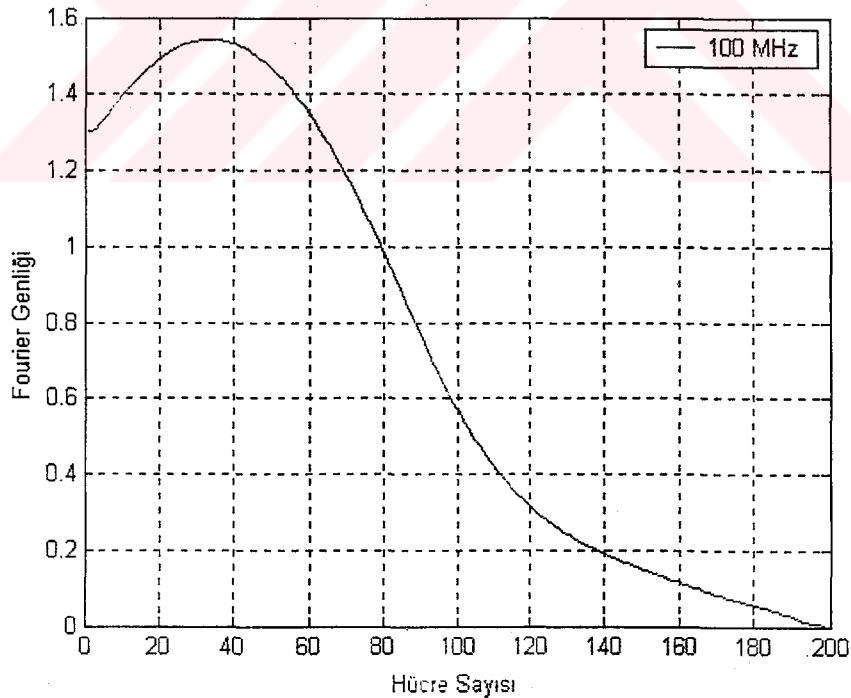
Ortam değişiminin olduğu hücre 100' üncü hücredir. Dikkat edilmelidir ki Fourier genliği 200 MHz de 50 MHz' den daha hızlı zayıflar. 500 MHz de zayıflama yine daha hızlıdır. Çünkü bu frekanslarda iletkenlik daha yüksektir. Aynı zamanda, daha düşük frekanslarda bağıl dielektrik sabitinin daha yüksek olması nedeniyle ortam içerisindeki genlik daha da küçülür. Bunu farklı frekanslar kullanıldığında da görmek mümkündür.



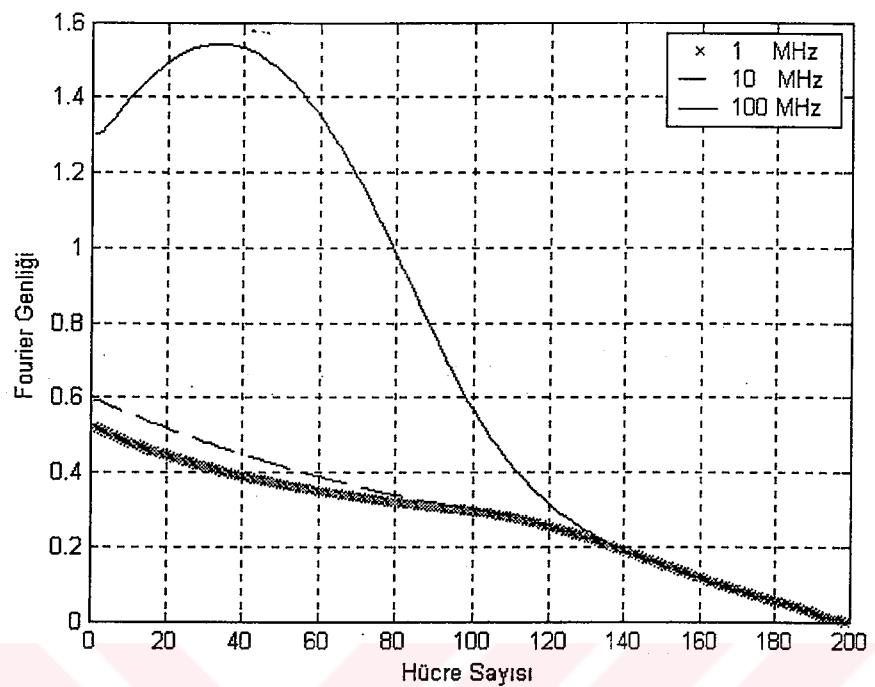
Şekil 3.25. 1-MHz için frekansa bağlı Fourier genliği değişimi (nsteps=500)



Şekil 3.26. 10-MHz için frekansa bağlı Fourier genliği değişimi (nsteps=500)



Şekil 3.27. 100-MHz için frekansa bağlı Fourier genliği değişimi (nsteps=500)



Şekil 3.28. 100 Her üç frekans için Fourier genliği değişimi (nsteps=500)

4. TARTIŞMA ve SONUÇ

Zamanda sonlu farklar metodu elektromanyetik teoride kullanılan, çözümü ve simülasyonu kolaylaştıran en önemli metodlardan biridir. Analitik yöntemlerle çözümü mümkün olan bir elektromanyetik problemin FDTD ile gerçekleştirilen çözümü, denklemlerin bilgisayar koduna dönüştürülmesinde ve çözüm yapabilen ve sonuçları görselleştiren bir yazılımın gerçekleştirilmesinde büyük kolaylık sağlamıştır.

Bu çalışmada üzerinde durulan temel konu farklı ortamlar içerisindeki elektromanyetik bir Gauss darbesi yada sinüzoidal alan hareketidir. Analitik olarak çözülebilen problem zamanda sonlu farklar metodu ile, zamana ve konuma bağlı olarak tekrar çözülmüş, iterasyon yapılarak ortam içerisinde dalganın simülasyonu sağlanmıştır. Elektromanyetik dalganın farklı bir ortama çarpmasını simüle eden yazılımlarda, ortam parametrelerine bağlı olarak dalganın bir kısmının geri yansıldığı bir kısmının ise ikinci ortam içerisinde iletildiği görülmüştür. Bu iletim sırasında iletkenlik faktörüne bağlı olarak dalga genliğinde meydana gelen zayıflamalarda program sonuçlarıyla tespit edilmiştir. FDTD ile elde edilen nümerik sonuçlar analitik çözümle karşılaştırılmış ve sonuçların mükemmel bir uyum içerisinde olduğu görülmüştür.

FDTD ile işlemler gerçekleştiriliırken karşılaşılan kompleks ifadelerin çözümündeki zorluklar, yardımcı diferansiyel eşitlik metodu ve z dönüşümü gibi farklı çözüm metodlarıyla ortadan kaldırılmıştır.

Asıl kompleks problem olarak görülen, frekansa bağlı olarak ortam parametrelerinin değiştiği durumları analiz eden yazılımlar da, yine FDTD çözümü yapılarak gerçekleştirilmiştir. Dielektrik sabiti ve iletkenlik parametrelerinin frekansa bağlı değişimi, ortam içerisindeki Fourier genliğinin bu parametrelerle nasıl değiştiğinin tespiti için bir yazılım hazırlanmasını gerekli kılmıştır. Hazırlanan yazılımlar hem ortamdaki elektrik ve manyetik alan değişimlerini, hem de Fourier genlik değişimlerini hesaplamaktadır. Bu yazılımlardan elde edilen sonuçlarla, yüksek

frekanslarda iletkenliğin daha yüksek olması nedeniyle, Fourier genliğinin ortam içerisinde daha hızlı zayıfladığı, ayrıca bağıl dielektrik sabitinin düşük frekanslarda daha yüksek olması nedeniyle ortam içerisindeki genliğin daha küçük olduğu tespit edilmiştir (Bkz. Şekil 3.24, Bkz. Şekil 3.28).

Bu çalışmada gerçekleştirilen tüm yazılımlar, çözüm bölgesi sınırlarının, ortam parametrelerinin, iterasyon sayısının, başlangıç koşullarının ve tanımlanan kaynağın değiştirilebilmesine imkan sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu, programların, başka tür elektromanyetik problem çözümlerinde referans olarak alınmasını ve üzerinde değişiklikler yapılarak yeni problem çözümüne adaptasyonunu sağlayacaktır.

Elektromanyetik alan yayılımının, günümüzde, biyomedikal ve haberleşme alanlarıyla askeri alanlardaki yaygın kullanımı, kayıp faktörünün önemli bir unsur olması, alan bileşenlerinin simülasyonlarla önceden tespitini gerekli kılmıştır. Bu çalışma da, simülasyona yönelik diğer araştırmalar gibi, bu yöndeki gelişmelere katkıda bulunacaktır.

5.KAYNAKLAR

- Balanis, C. A., 1989. Advanced Engineering Electromagnetics, 861s. Wiley, Newyork
- Grote, M. J., 2000. Non Reflecting Boundary Conditions for Electromagnetic Scattering. International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks Devices and Fields 13, 397-416, Switzerland.
- Haznadar, Z., Stih, Z., 2000. Electromagnetic Fields, Waves and Numerical Methods, IOS Press, 411 s. Netherlands
- Inumaru, T., Hashimoto O., 2000. FDTD Analysis for Protecting Human Body From Electromagnetic Wave Using Thin Resistive Sheet. Electronics and Communication in Japan, 83(9), 719-724, Japan.
- Kunz, K. S., Luebbers, R. J., 1993. The Finite Difference Time Domain Method for Electromagnetics, CRC Press, 448 s. Boca Raton
- Routhwell, E. J., Cloud, M. J., 2001. Electromagnetics, CRC Press, 384 s. Boca Raton
- Sadiku, M. N. O., 2000. Numerical Techniques in Electromagnetics, CRC Press, 760s. Boca Raton
- Taflove A., 1995. Computational Electrodynamics: The Finite Difference Time Domain Method, Artech House, 510 s. Boston
- Umashankar, K., Taflove A., 1993. Computational Electromagnetics, Artech House, Boston

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Ömer Halil ÇOLAK

Doğum Yeri : ISPARTA

Doğum Yılı : 13/03/1979

Medeni Hali : Bekar

Eğitim ve Akademik Durumu:

Lise 1992-1995 :Elazığ Lisesi

Lisans 1995-1999 :Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Yabancı Dil : İngilizce

İş Deneyimi:

2000 – :Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü' nde Araştırma Görevliliği